#### HPM5300 系列高性能微控制器数据手册 Rev0.4

- 32 位 RISC-V 处理器
  - 支持 RV32-IMAFDCPB 指令集
  - 3.57 Coremark/MHz, 1.98
     DMIPS/MHz
  - DSP 单元, 支持 SIMD 和 DSP 指令
  - L1 指令缓存和数据缓存各 16KB
  - 指令本地存储器 ILM 和数据本地存储器 DLM 各 128KB
- 内置存储器
  - 共 288 KB 片上 SRAM,包括通用内存和 CPU 的本地存储器
  - 1 MB 内置闪存
  - 4096 位 OTP
  - 128 KB BOOT ROM
- 电源和时钟
  - 多个片上电源,包括 DCDC 和 LDO
  - 低功耗模式,运行模式、等待模式、 停止模式、休眠模式和关机模式
  - 24MHz 晶体振荡器
  - 24MHz 和 32KHz 内部 RC 振荡器
  - 2 个 PLL, 支持小数分频、展频
- 外部存储器接口
  - 1 个串行总线控制器 XPI,支持各类外部串行 Flash 和 PSRAM
- 运动控制系统
  - 2 个 PWM 定时器
  - 2 个正交编码器输入 QEIv2 和 2 个 正交编码器输出 QEO
  - 2 个串行编码器接口 SEI
  - 2 个运动管理控制器 MMC
  - 1 个旋变解码器 RDC
  - 1 个可编程逻辑模块 PLB
- 定时器

- 5 组 32 位通用定时器
- 3 个看门狗
- 实时时钟
- 通讯接口
  - 9个UART、4个SPI、4个I2C
  - 1 个 USB 2.0 OTG,集成 HS-PHY
  - 4 个 CAN 控制器, 支持 CAN-FD
  - 4 个 LINv2 控制器
- 高性能模拟外设
  - 2 个 ADC, 16 位/2MSPS, 可配置为
     12 位/4MSPS, 共支持 16 路模拟输入引脚
  - 2 个 12 位 DAC, 1MSPS
  - 2 个模拟比较器
  - 2 个运算放大器
- 输入输出
  - 56 个 GPIO
  - IO 支持 3.3V 和 1.8V
- 信息安全
  - AES-128/256 加解密引擎,支持
     ECB,CBC 模式
  - 支持 SM2, SM3, SM4
  - SHA-1/256 哈希模块
  - 真随机数发生器
  - NOR Flash 实时解密

#### 产品型号:

HPM5361ICB1、HPM5361ICF1、

HPM5361IEG1

HPM5331ICB1、HPM5331ICF1、

HPM5331IEG1

HPM5321ICB1、HPM5321ICF1、

HPM5321IEG1



# **HPM5300 系列** 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

## 景目

1	产品模	述		 	 	 	 3
	1.1	系统框图		 	 	 	 . 3
	1.2	特性总结		 	 	 	 . 5
		1.2.1 内核与系统		 	 	 	 . 5
		1.2.2 内部存储器		 	 	 	 . 6
		1.2.3 电源管理		 	 	 	 . 6
		1.2.4 时钟		 	 	 	 . 6
		1.2.5 复位		 	 	 	 . 7
		1.2.6 启动		 	 	 	 . 7
		1.2.7 外部存储器		 	 	 	 . 7
		1.2.8 运动控制系统		 	 	 	 . 7
		1.2.9 定时器		 	 	 	 . 8
		1.2.10 通讯外设		 	 	 	 . 8
		1.2.11 模拟外设		 	 	 	 . 8
		1.2.12 输入输出		 	 	 	 . 8
		1.2.13 信息安全系统		 	 	 	 . 9
		1.2.14 系统调试		 	 	 	 . 9
2	引脚及	功能描述		 	 	 	 11
	2.1	LQFP100 引脚分布 .		 	 	 	 . 11
	2.2	LQFP64 引脚分布		 	 	 	 . 12
	2.3	QFN48 引脚分布		 	 	 	 . 13
	2.4	引脚配置及功能 PINMU	JX	 	 	 	 . 14
	2.5	特殊功能引脚		 	 	 	 . 36
	2.6	IO 复位状态		 	 	 	 . 36
3	电源			 	 	 	 . 37
	3.1	电源框图		 	 	 	 . 37
	3.2	上下电时序					
4	由气体	性		 	 	 	 . 37
•		工作条件					
		エロ					_
		4.1.2 正常工作条件	-				_
	4.2	内置闪存特性					
		VPMC 欠压检测					
	4.4	振荡器					
		4.4.1 24MHz 振荡器 <sup>5</sup>					
		4.4.2 32KHz RC 振荡	•				
		4.4.3 24MHz RC 振落					
		4.4.4 PLL 特性					
	4.5	外设时钟特性					
		工作模式					
			· · ·	 	 	 	 



## HPM5300 系列

其工	RISC-V	内核的	32	位高性能微控制器数据手册F	2ev0.2
本工	11100-1	ハルタロル	υZ	以同注形放红巾给女灯后十刀厂	\CVU.~

基于 RIS	SC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4	目录
4.7	供电电流特性	. 41
4.8	I/O 特性	. 42
	4.8.1 I/O DC 特性	. 42
	4.8.2 I/O AC 特性	. 43
4.9	JTAG 接口	. 44
4.10	) XPI 存储器接口	. 45
	4.10.1 DC 特性	. 45
	4.10.2 AC 特性	. 45
4.11	模拟接口	. 50
	4.11.1 16 位模数转换 ADC 特性	. 50
	4.11.2 比较器 ACMP 特性	. 51
	4.11.3 12 位数模转换器 DAC 特性	. 51
	4.11.4 运算放大器 OPAMP 特性	. 52
4.12	? SPI 接口	. 58
	4.12.1 SPI 主模式时序图	. 58
	4.12.2 SPI 从模式时序图	. 59
4.13	3 I2C 接口	. 60
5 封装		. 61
5.1	LQFP100 封装尺寸	. 61
5.2	LQFP64 封装尺寸	. 62
5.3	QFN48 封装尺寸	. 63
5.4	封装热阻系数	. 63
6 订购(	· 信息	. 64
	··· - - 产品命名规则	
6.2	ブ购信息	
6.3	封装引出功能差异	
<b>-</b> 1000 - 100		



## 表格目录

	外设简称总结	 Ü
2	SOC IOMUX	 34
3	PMIC IOMUX	 35
4	启动配置表	 36
5	特殊功能引脚配置	 36
6	IO 复位状态表	 36
7	最大值和最小值	 37
8	正常工作条件	 38
9	内置闪存特性	 39
10	VPMC 欠压检测特性	 39
11	24MHz 晶振	 40
12	32KHz RC 振荡器	 40
13	24MHz RC 振荡器	 40
14	PLL 特性参数	 40
15	工作模式配置表	 41
16	运行模式的典型电流	 41
17	IDD(VPMC) 典型电流	 41
18	IDD(VANA) 典型电流	 42
19	IDD(VPLL) 典型电流	 42
20	IO 工作条件	 42
21	I/O AC 特性	 43
22	JTAG 时序参数	 44
23	XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0)	
24	XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1)	 45
25	XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 ,情形 1)	 46
26	XPI SDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3 ,情形 2)	 46
27	XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0)	 47
28	XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1)	 47
29	XPI DDR 模式的输入特性(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3	 48
30	<b>XPI SDR</b> 模式的输出信号时序	
31	<b>XPI DDR</b> 模式的输出信号时序	
32	16 位 ADC 参数	 50
33	比较器参数	 51
34	12 位 DAC 参数	 52
35	OPAMP 参数	 57
36	SPI 主模式参数 (注: tperiph = 1000 / fperiph)	 59
37	SPI 从模式参数 (注: tperiph = 1000 / fperiph)	 60
38	I2C 工作模式及参数	 60
39	各封装热阻系数表	
	订购信息	0.5



**HPM5300 系列** 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

41	封装引出功能差异	66
42	版本信息	67



# **HPM5300 系列** 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

## 图片目录

1	系统架构框图	3
2	LQFP100 引脚分布	11
3	LQFP64 引脚分布	12
4	QFN48 引脚分布	13
5	上电时序要求	37
6	I/O AC 特性	43
7	JTAG 时序图	44
8	XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1)	45
9	XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 1)	46
10	XPI SDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 2)	46
11	XPI DDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1)	47
12	XPI DDR 模式的输入时序(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3)	47
13	XPI SDR 模式的输出信号	48
14	XPI DDR 模式的输出信号	48
15	SPI 主模式时序(CPHA=0)	58
16	SPI 主模式时序(CPHA=1)	58
17	SPI 从模式时序(CPHA=0)	59
18	SPI 从模式时序(CPHA=1)	59
19	LQFP100 封装尺寸图	61
20	LQFP64 封装尺寸图	62
21	QFN48 封装尺寸图	63
22	产品命名规则	64



### 1 产品概述

#### 1.1 系统框图

本产品的系统框图如图 1。

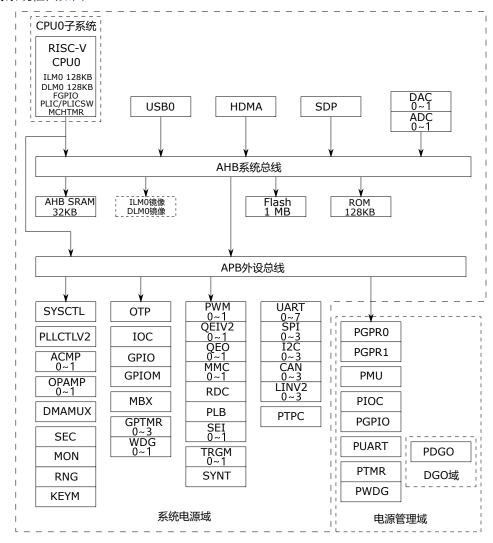


图 1: 系统架构框图

表 1总结了图 1中所有外设简称的释义。

简称	描述	
CPU0 子系统 包含 RISC-V CPU0 及其本地存储器和私有外设的子系统		
HART 硬件线程(Hardware Thread),RISC-V 规范定义一个可以包含		
	RISC-V 体系架构,并可以独立执行指令的单元为 HART。本手册中,	
	HART 等同与 RISC-V 内核。	
ILM	指令本地存储器(Instruction Local Memory)	
DLM	数据本地存储器(Data Local Memory)	
FGPIO	快速 GPIO 控制器(Fast General Purpose Input Output)	
USB	通用串行总线(Universal Serial Bus)	



简称	描述
SDP	安全数据处理器(Secure Data Processor)
HDMA	AHB 外设总线 DMA 控制器(AHB DMA)
AHB SRAM	AHB 总线 SRAM
EXIP	在线解密模块(Encrypted Execution-In-Place)
ADC	模数转换器(Analog-to-Digital Convertor)
DAC	数模转换器(Digital-to-Analog Convertor)
SYSCTL	系统控制模块(System Control)
PLLCTL	锁相环控制器(PLL Controller)
ACMP	模拟比较器(Analog Comparator)
MBX	信箱(Mailbox)
DMAMUX	DMA 请求路由器
IOC	IO 控制器(Input Output Controllor)
PIOC	电源管理域 IO 控制器
GPIO	通用输入输出控制器(General Purpose Input Output)
PGPIO	电源管理域 GPIO 控制器
GPIOM	GPIO 管理器(GPIO Manager)
OTP	一次性可编程存储(One Time Program)
PWM	PWM 定时器(Pulse Width Modulation)
QEIv2	正交编码器输入(Quadrature Encoder Input)
QEO	正交编码器输出(Quadrature Encoder Output)
SEI	串行编码器接口(Serial Encoder Interface)
MMC	运动管理控制器(Motion Management Controller)
RDC	旋转变压器接口(Resolver Decoder)
PLB	可编程逻辑单元(Programmable Logic Block)
TRGM	互联管理器(Trigger Manager)
SYNT	同步定时器(Sync Timer)
GPTMR	通用定时器(General Purpose Timer)
PTMR	电源管理域内的通用定时器
EWDG	看门狗(Watchdog)
PWDG	电源管理域内的看门狗
UART	通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)
PUART	电源管理域内的通用异步收发器
SPI	串行外设接口(Serial Peripheral Interface)
I2C	集成电路总线(Inter-Integrated Circuit)
CAN	控制器局域网(Control Area Network)
LINv2	局域互联网络(Local Interconnect Network)
PTPC	精确时间协议模块(Precise Time Protocol)
RNG	随机数发生器(Random Number Generator)
KEYM	密钥管理器(Key Manager)
PGPR0/1	电源管理域的通用寄存器 0/1



简称	描述		
PCFG	电源管理域配置模块		
PDGO 电源管理域开关机模块			
SEC	安全管理器		
MON	安全监视器		
系统电源域	本手册中,系统电源域专指由 VDD_SOC 供电的逻辑和存储电路		
电源管理域	本手册中,电源管理域专指由 VPMC 供电的逻辑和存储电路		

表 1: 外设简称总结

#### 1.2 特性总结

本章节介绍本产品的主要特性。

#### 1.2.1 内核与系统

32 位 RISC-V 处理器, 处理器特性如下:

- RV32-IMAFDCPB 指令集
  - 整数指令集
  - 乘法指令集
  - 原子指令集
  - 单精度浮点数指令集
  - 双精度浮点数指令集
  - 压缩指令集
  - DSP 单元,支持 SIMD 和 DSP 指令,兼容 RV32-P 扩展指令集
  - 位运算指令集
- 性能可达 3.57 CoreMark / MHz
- 特权模式支持 Machine 模式和 User 模式
- 支持 16 个物理内存保护(Physical Memory Protection PMP)区域
- 支持 16KB L1 指令缓存和 16KB L1 数据缓存
- 支持 128 KB 指令本地存储器 ILM 和 128 KB 数据本地存储器 DLM

处理器配备 1 个平台中断控制器 PLIC, 用于管理 RISC-V 的外部中断

- 支持多个中断源
- 支持8级可编程中断优先级
- 中断嵌套扩展和中断向量扩展

处理器内核配备 1 个软件中断控制器 PLICSW,管理 RISC-V 的软件中断

• 生成 RISC-V 软件中断

处理器内核配备 1 个机器定时器 MCHTMR,管理 RISC-V 的定时器中断

● 生成 RISC-V 定时器中断

DMA 控制器:

● HDMA,支持 32 个通道,用于在外设寄存器和存储器之间进行低延迟的数据搬移,也可以用于存储器之间的数据搬移



• 支持 DMA 请求路由分配到任意 DMA 控制器

包括 1 个邮箱 MBX,支持处理器不同进程间的通信:

- 支持独立的信息收发接口
- 支持生成中断

#### 1.2.2 内部存储器

内部存储器包括:

- 288 KB 的片上 SRAM
  - ILMO, RISC-V CPU0 的指令本地存储器, 128KB
  - DLM0, RISC-V CPU0 的数据本地存储器, 128KB
  - AHB SRAM, 32KB, 适用于 HDMA 的低延时访问
- 通用寄存器
  - 电源管理域通用寄存器 PGPR, 2 组各 64 字节 (共 128 字节),可以在系统电源域掉电时保存数据
  - DGO 通用寄存器 DGO GPR,容量 16 字节,可以在系统电源域,电源管理域掉电时保存数据
- 内部只读存储器 ROM,容量 128KB, ROM 存放本产品的启动代码,闪存加载(Flashloader)和部分外设驱动程序
- 一次性可编程存储器 OTP, 4096 位,可用于存放芯片的部分出厂信息,用户密钥和安全配置,启动配置等数据

#### 1.2.3 电源管理

本产品集成了完整的电源管理系统:

- 多个片上电源
  - DCDC 电压转换器,提供 0.9~1.3V 输出,为系统电源域的电路供电,可调节 DCDC 输出,以 支持动态电压频率调整 DVFS,来优化运行时的功耗
  - LDOPMC, 典型值 1.1V 输出的线性稳压器, 为电源管理域的电路供电
  - LDOOTP, 典型值 2.5V 输出的线性稳压器, 为 OTP 供电, 仅可在烧写 OTP 时打开
- 运行模式和低功耗模式: 等待模式、停止模式、休眠模式和关机模式
- 芯片集成上电复位电路
- 芯片集成低压检测电路

#### 1.2.4 时钟

本产品时钟管理系统支持多个时钟源和时钟低功耗管理:

- 外部时钟源:
  - 24MHz 片上振荡器, OSC24M, 支持 24MHz 晶体, 也支持通过引脚从外部输入 24MHz 有源时钟
- 内部时钟源:
  - 内部 RC 振荡器, RC24M, 频率 24MHz, 允许配置内部 RC 振荡器作为 PLL 的候补时钟源
  - 内部 32KHz RC 振荡器, RC32K
- 2 个锁相环 PLL, 支持小数分频, 支持展频
- 支持低功耗管理, 支持自动时钟门控



#### 1.2.5 复位

全局复位,可以复位整个芯片,包括电源管理域和系统电源域,复位源有:

● RESETN 引脚复位 (RESETN)

系统电源域复位可以复位系统电源域,复位源有:

- VPMC 引脚的低压复位(VPMC Brownout)
- 调试复位(DEBUG RST)
- 看门狗复位(WDOGx RST)
- 软件复位 (SW RST)

#### 1.2.6 启动

BootROM 为该芯片上电后执行的第一段程序, 它支持如下功能:

- 从串行 NOR FLASH 启动
- UART/USB 启动
- 在系统编程 (ISP)
- 安全启动
- 低功耗唤醒
- 多种 ROM API

#### 1.2.7 外部存储器

外部存储器接口包括:

- 1 个串行总线控制器 XPI,可以连接片外的各种 SPI 串行存储设备,也可以连接支持串行总线的器件,每个 XPI:
  - 支持 1/2/4 位数据模式,支持 2 个 CS 片选信号
  - 支持 SDR 和 DDR, 最高支持 166MHz
  - 支持 Quad-SPI 和 Octal-SPI 的串行 NOR Flash
  - 支持串行 NAND Flash
  - 支持 HyperBus, HyperRAM 和 HyperFlash
  - 支持 Quad/Oct SPI PSRAM

#### 1.2.8 运动控制系统

运动控制系统包括:

- 2 组电机控制系统,每组电机控制系统配备有:
  - 2 个 8 通道 PWM 定时器 PWM, PWM 调制精度达 3.0ns, 支持产生互补 PWM 输出, 死区插入和故障保护
  - 2 个正交编码器输入 QEIv2
  - 2 个正交编码器输出 QEO
  - 2 个运动管理控制器 MMC
  - 1 个旋转变压器解码 RDC
  - 1 个可编程逻辑单元 PLB
  - 2 个串行编码器接口 SEI



- 1 个互联管理器 TRGM
- 各模块支持通过互联管理器 TRGM 与电机控制系统内部或外部的模块交互
- 1 个同步定时器, 用于同步

#### 1.2.9 定时器

定时器包括:

- 5组32位通用定时器,其中一组(PTMR)位于电源管理域,支持低功耗唤醒,每组通用定时器包括4个32位计数器
- 3 个看门狗, 其中一个 (PWDG) 位于电源管理域

#### 1.2.10 通讯外设

支持丰富的通讯外设,包括:

- 9 个通用异步收发器 UART, 其中 1 个 (PUART) 位于电源管理域, 支持低功耗唤醒
- 4 个串行外设接口 SPI
- 4 个集成电路总线 I2C,支持标准(100kbps),快速(400kbps)和快速 + (1 Mbps)
- 4 个控制器局域网 CAN, 支持 CAN\_FD
  - 支持 CAN 2.0B 标准, 1Mbps
  - 支持 CAN FD, 8 Mbps
  - 支持时间戳
- 1 个精确时间协议模块 PTPC, PTPC 支持 2 组时间戳模块,每组包含 64 位计数器,连接到 CAN 模块, CAN 模块可以随时从端口读取时间戳信息
- 4 个局域互联网络 LIN
- 1 个 USB OTG 控制器,集成 1 个高速 USB-PHY
  - 符合 Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0

#### 1.2.11 模拟外设

模拟外设包括:

- 2 个 16 位模拟数字转换器 ADC
  - 16 位逐次逼近型 ADC
  - 支持 16 个输入通道
  - 2M 采样率, 4M 采样率 (转换精度设置为 12 位)
- 2 个高速比较器
  - 工作电压 3.0~3.6V, 支持轨到轨输入
  - 内置 8 位 DAC
- 2 个数模转换器 DAC
  - 12 位精度, 1MSPS, 支持输出缓存
- 2 个运算放大器 OPAMP
  - 支持 PGA 模式

#### 1.2.12 输入输出

- 提供 PA~PY 共 8 组最多 56 个 GPIO 功能复用引脚
- IO 支持 3V 电压模式, 分组供电



- IO 支持开漏控制、内部上下拉、驱动能力调节,内置施密特触发器
- GPIO 控制器
  - 支持读取任意 IO 的输入或者控制 IO 的输出
  - 支持 IO 输入触发中断
- 快速 GPIO 控制器 FGPIO,作为处理器私有的 IO 快速访问接口
- 提供一个 GPIO 管理器,管理各 GPIO 控制器的 IO 控制权限
- 电源管理域专属 IO PYxx 拥有专属 GPIO 控制器和 IO 配置模块,支持低功耗模式下状态保持

#### 1.2.13 信息安全系统

信息安全模块包含:

- 安全数据处理器 SDP, 为片上加解密算法引擎:
  - 支持 AES-128/256, SM4, 支持 ECB 模式和 CBC 模式
  - 支持 SHA-1/SHA-256, SM3
- 在线解密模块 EXIP:
  - 与串行总线控制器 XPI 紧密耦合,支持外部 NOR Flash 在线解密
  - AES-128 CTR 模式,零等待周期解密
  - 支持 RFC3394 的密钥解封,通过密钥加密密钥 KEK 保护数据加密密钥 DEK
- 密钥管理器 KEYM:
  - 支持通过独立的数据通路从 OTP 的密钥区载入密钥
  - 支持密钥混淆
  - 支持从真随机数发生器 RNG 载入随机密钥
  - 支持生成 Session Key
  - 支持独立的数据通路将密钥传送到安全数据处理器 SDP
- OTP 中的密钥区,支持存放并保护;
  - SDP, EXIP 的相关密钥
  - 安全启动的相关密钥
  - 安全调试相关密钥
  - 产品生命周期配置
- 真随机数发生器 RNG:
  - 3 个独立熵源为内部模拟噪声源
- 安全管理器 SEC:
  - 监测产品生命周期
  - 配置系统安全状态,
  - 制定安全规则并监测安全规则违反的事件
  - 关联监视器 MON,监测 VPMC 供电和时钟 OSC24M
- 基于 BOOT ROM 的安全启动机制,支持加密启动,支持可信的执行环境

#### 1.2.14 系统调试

系统调试模块包括:

- 支持 JTAG 接口
  - 支持 RISC-V External Debug Support V0.13 规范
  - 支持 IEEE1149.1



## 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

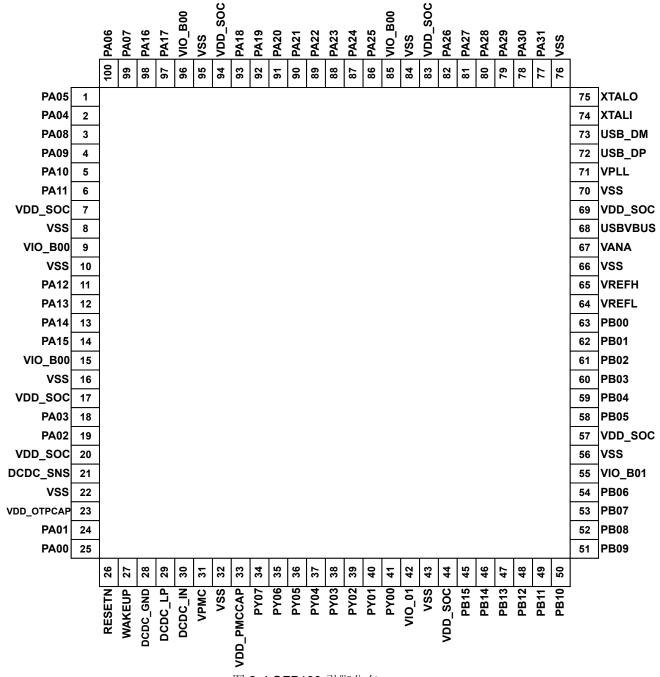
- 访问 RISC-V 内核寄存器和 CSR, 访问存储器
- 调试端口锁定功能
  - 开放模式,调试功能开放
  - 锁定模式,调试功能关闭,可以通过调试密钥解锁
  - 关闭模式,调试功能关闭

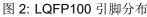


## 2 引脚及功能描述

#### 2.1 LQFP100 引脚分布

LQFP100 分布 (顶部视图) 如图 2。







#### 2.2 LQFP64 引脚分布

LQFP64 分布 (顶部视图) 如图 3。

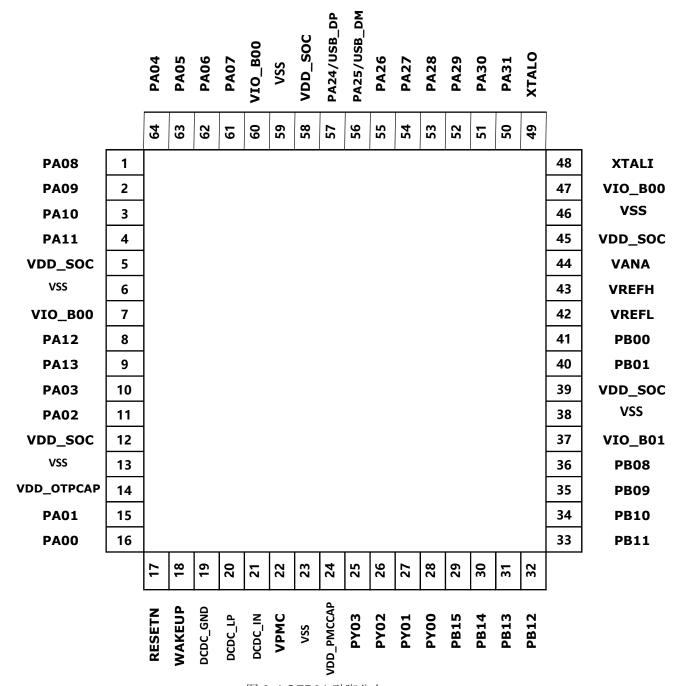


图 3: LQFP64 引脚分布



### 2.3 QFN48 引脚分布

QFN48 分布 (顶部视图) 如图 4。

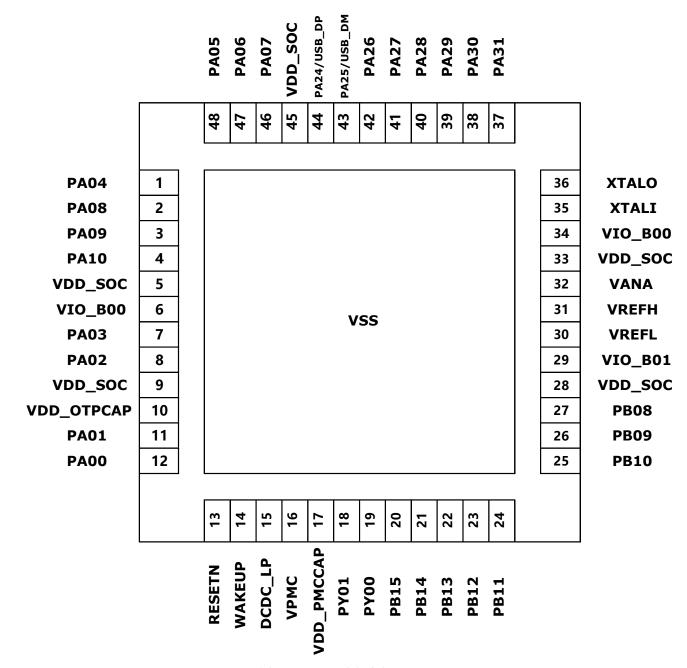


图 4: QFN48 引脚分布



## 2.4 引脚配置及功能 PINMUX

HPM5300 系列的引脚配置及功能如下:

LQFP _100	LQFP _64	QFN_ 48	PIN 名称	数字功能	模拟功能
25	16	12	PA00	GPIO_A_00(ALT0) GPTMR1_COMP_0(ALT1) UART0_TXD(ALT2) LIN0_TXD(ALT6) CAN0_TXD(ALT7) PWM0_FAULT_0(ALT16) PWM1_P_0(ALT17) TRGM0_P_00(ALT18) PWM1_FAULT_0(ALT19) SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT 24)	-
24	15	11	PA01	GPIO_A_01(ALT0) GPTMR1_CAPT_0(ALT1) UART0_RXD(ALT2) LIN0_RXD(ALT6) CAN0_RXD(ALT7) PWM0_FAULT_1(ALT16) PWM1_P_1(ALT17) TRGM0_P_01(ALT18) ACMP_COMP_0(ALT19) SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT 24)	-
19	11	8	PA02	GPIO_A_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C0_SCL(ALT4) LIN0_TREN(ALT6) CAN0_STBY(ALT7) ACMP_COMP_0(ALT16) PWM1_P_2(ALT17) TRGM0_P_02(ALT18) ACMP_COMP_1(ALT19) QEI1_F(ALT20) SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT 24)	-



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_A_03(ALT0)	
				GPTMR1_CAPT_1(ALT1)	
				UART0_CTS(ALT3)	
				I2C0_SDA(ALT4)	
				SPI3_CS_3(ALT5)	
				CAN1_STBY(ALT7)	
18	10	7	PA03	ACMP_COMP_1(ALT16)	-
				PWM1_P_3(ALT17)	
				TRGM0_P_03(ALT18)	
				PWM1_FAULT_1(ALT19)	
				QEI1_H1(ALT20)	
				SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT	
				24)	
				GPIO_A_04(ALT0)	
				UART1_CTS(ALT3)	
				SPI0_CS_0(ALT5)	
				CAN1_RXD(ALT7)	
				PWM0_P_0(ALT16)	
2	64	1	PA04	PWM1_P_4(ALT17)	_
		'	17.04	TRGM0_P_04(ALT18)	
				RDC0_EXC_P(ALT19)	
				QEI1_A(ALT20)	
				QEO1_A(ALT21)	
				SEI1_DE(ALT22)	
				JTAG_TDO(ALT24)	



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_A_05(ALT0)	
				GPTMR1_COMP_2(ALT1)	
				UART1_DE(ALT2)	
				UART1_RTS(ALT3)	
				SPI0_SCLK(ALT5)	
				LIN1_TREN(ALT6)	
				CAN1_TXD(ALT7)	
1	63	48	PA05	PWM0_P_1(ALT16)	-
				PWM1_P_5(ALT17)	
				TRGM0_P_05(ALT18)	
				RDC0_EXC_N(ALT19)	
				QEI1_B(ALT20)	
				QEO1_B(ALT21)	
				SEI1_CK(ALT22)	
				JTAG_TDI(ALT24)	
				GPIO_A_06(ALT0)	
				GPTMR0_CAPT_0(ALT1)	
				UART1_RXD(ALT2)	
				I2C1_SDA(ALT4)	
				SPI0_MISO(ALT5)	
				LIN1_TXD(ALT6)	
100	62	47	PA06	PWM0_P_2(ALT16)	-
				PWM1_P_6(ALT17)	
				TRGM0_P_06(ALT18)	
				QEI1_Z(ALT20)	
				QEO1_Z(ALT21)	
				SEI1_TX(ALT22)	
				JTAG_TCK(ALT24)	



	封装						
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能		
_100	_64	48					
				GPIO_A_07(ALT0)			
				GPTMR0_COMP_0(ALT1)			
				UART1_TXD(ALT2)			
				I2C1_SCL(ALT4)			
				SPI0_MOSI(ALT5)			
99	61	46	PA07	LIN1_RXD(ALT6)			
99	01	40	PAUI	PWM0_P_3(ALT16)	-		
				PWM1_P_7(ALT17)			
				TRGM0_P_07(ALT18)			
				QEI1_H0(ALT20)			
				SEI1_RX(ALT22)			
				JTAG_TMS(ALT24)			
						GPIO_A_08(ALT0)	
				GPTMR0_COMP_1(ALT1)			
				UART2_TXD(ALT2)			
				I2C2_SCL(ALT4)			
3	1	2	PA08	SPI3_CS_2(ALT5)	-		
				CAN2_TXD(ALT7)			
				PWM0_P_4(ALT16)			
				PWM0_FAULT_0(ALT18)			
				JTAG_TRST(ALT24)			
				GPIO_A_09(ALT0)			
				GPTMR0_CAPT_1(ALT1)			
				UART2_RXD(ALT2)			
				I2C2_SDA(ALT4)			
4	2	3	PA09	SPI3_CS_1(ALT5)	-		
				CAN2_RXD(ALT7)			
				PWM0_P_5(ALT16)			
				PWM0_FAULT_1(ALT18)			
				SOC_REF0(ALT24)			



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
5	3	4	PA10	GPIO_A_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) SPI3_CS_0(ALT5) LIN2_RXD(ALT6) CAN2_STBY(ALT7) PWM0_P_6(ALT16) PWM1_FAULT_0(ALT17) ACMP_COMP_0(ALT18) QEI1_A(ALT20) QEO0_A(ALT21)	-
6	4	-	PA11	SEI1_DE(ALT22)  GPIO_A_11(ALT0)  UART2_CTS(ALT3)  SPI3_SCLK(ALT5)  LIN2_TXD(ALT6)  PWM0_P_7(ALT16)  PWM1_FAULT_1(ALT17)  ACMP_COMP_1(ALT18)  QEI1_B(ALT20)  QEO0_B(ALT21)  SEI1_CK(ALT22)  WDG0_RST(ALT24)	-
11	8	-	PA12	GPIO_A_12(ALT0) UART3_CTS(ALT3) I2C3_SDA(ALT4) SPI3_MISO(ALT5) LIN2_TREN(ALT6) PWM0_P_0(ALT16) PWM1_FAULT_0(ALT17) PWM0_FAULT_0(ALT18) RDC0_EXC_P(ALT19) QEI1_Z(ALT20) QEO0_Z(ALT21) SEI1_TX(ALT22) SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT 24)	-



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_A_13(ALT0)	
				GPTMR1_COMP_3(ALT1)	
				UART3_DE(ALT2)	
				UART3_RTS(ALT3)	
				I2C3_SCL(ALT4)	
				SPI3_MOSI(ALT5)	
				LIN3_TREN(ALT6)	
12	9	_	PA13	CAN3_STBY(ALT7)	_
12			17(10	PWM0_P_1(ALT16)	
				PWM1_FAULT_1(ALT17)	
				PWM0_FAULT_1(ALT18)	
				RDC0_EXC_N(ALT19)	
				QEI1_H0(ALT20)	
				SEI1_RX(ALT22)	
				SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT	
				24)	
				GPIO_A_14(ALT0)	
				UART3_RXD(ALT2)	
				SPI3_DAT2(ALT5)	
				LIN3_RXD(ALT6)	
13	-	-	PA14	CAN3_RXD(ALT7)	-
				PWM0_P_2(ALT16)	
				ACMP_COMP_0(ALT18)	
				QEI1_H1(ALT20)	
				WDG1_RST(ALT24)	
				GPIO_A_15(ALT0)	
				GPTMR0_COMP_3(ALT1)	
				UART3_TXD(ALT2)	
				SPI3_DAT3(ALT5)	
14	-	-	PA15	LIN3_TXD(ALT6)	-
				CAN3_TXD(ALT7)	
				PWM0_P_3(ALT16)  ACMP_COMP_1(ALT18)	
				QEI1_F(ALT20)	
				SOC_REF0(ALT24)	



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_A_16(ALT0)	
				GPTMR3_COMP_0(ALT1)	
				UART4_TXD(ALT2)	
				LIN0_TXD(ALT6)	
98			PA16	CAN0_TXD(ALT7)	
90	-	-	PATO	PWM0_P_4(ALT16)	-
				PWM1_P_0(ALT17)	
				TRGM0_P_04(ALT18)	
				QEO0_A(ALT21)	
				SEI1_DE(ALT22)	
				GPIO_A_17(ALT0)	
			- PA17	GPTMR3_CAPT_0(ALT1)	
				UART4_RXD(ALT2)	
				LIN0_RXD(ALT6)	
0.7				CAN0_RXD(ALT7)	
97	-	-	PAT	PWM0_P_5(ALT16)	-
					PWM1_P_1(ALT17)
				TRGM0_P_05(ALT18)	
				QEO0_B(ALT21)	
				SEI1_CK(ALT22)	
				GPIO_A_18(ALT0)	
				GPTMR3_COMP_1(ALT1)	
				UART4_DE(ALT2)	
				UART4_RTS(ALT3)	
				I2C0_SCL(ALT4)	
93			PA18	LIN0_TREN(ALT6)	
93	-	-	PATO	CAN0_STBY(ALT7)	-
				PWM0_P_6(ALT16)	
				PWM1_P_2(ALT17)	
				TRGM0_P_06(ALT18)	
				QEO0_Z(ALT21)	
				SEI1_TX(ALT22)	



	封装										
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能						
_100	_64	48									
				GPIO_A_19(ALT0)							
				GPTMR3_CAPT_1(ALT1)							
				UART4_CTS(ALT3)							
				I2C0_SDA(ALT4)							
92	_	_	PA19	SPI1_CS_3(ALT5)	_						
32	_	_	1719	CAN1_STBY(ALT7)	-						
				PWM0_P_7(ALT16)							
				PWM1_P_3(ALT17)							
				TRGM0_P_07(ALT18)							
				SEI1_RX(ALT22)							
				GPIO_A_20(ALT0)							
				UART5_CTS(ALT3)							
					SPI2_CS_0(ALT5)						
			PA20	CAN1_RXD(ALT7)							
91				PWM0_FAULT_0(ALT16)							
91	_	-	-	-	-	-	-	-	FAZU	PWM1_P_4(ALT17)	-
				TRGM0_P_00(ALT18)							
				QEI0_A(ALT20)							
						QEO0_A(ALT21)					
				SEI0_DE(ALT22)							
				GPIO_A_21(ALT0)							
				GPTMR3_COMP_2(ALT1)							
				UART5_DE(ALT2)							
				UART5_RTS(ALT3)							
				SPI2_SCLK(ALT5)							
				LIN1_TREN(ALT6)							
90	-	-	PA21	CAN1_TXD(ALT7)	-						
				PWM0_FAULT_1(ALT16)							
				PWM1_P_5(ALT17)							
				TRGM0_P_01(ALT18)							
				QEI0_B(ALT20)							
				QEO0_B(ALT21)							
				SEI0_CK(ALT22)							



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_A_22(ALT0)	
				GPTMR2_CAPT_0(ALT1)	
				UART5_RXD(ALT2)	
				I2C1_SDA(ALT4)	
				SPI2_MISO(ALT5)	
89	_	_	PA22	LIN1_TXD(ALT6)	_
03	_	_	1 722	PWM1_P_6(ALT17)	-
				TRGM0_P_02(ALT18)	
				PWM1_FAULT_0(ALT19)	
				QEI0_Z(ALT20)	
				QEO0_Z(ALT21)	
				SEI0_TX(ALT22)	
				GPIO_A_23(ALT0)	
				GPTMR2_COMP_0(ALT1)	
				UART5_TXD(ALT2)	
				I2C1_SCL(ALT4)	
				SPI2_MOSI(ALT5)	
88	-	-	PA23	LIN1_RXD(ALT6)	-
				PWM1_P_7(ALT17)	
				TRGM0_P_03(ALT18)	
				PWM1_FAULT_1(ALT19)	
				QEI0_H0(ALT20)	
				SEI0_RX(ALT22)	
				GPIO_A_24(ALT0)	
				GPTMR2_COMP_1(ALT1)	
				UART6_TXD(ALT2)	
				I2C2_SCL(ALT4)	
				SPI1_CS_2(ALT5)	
87	57	44	PA24	CAN2_TXD(ALT7)	-
				XPI0_CA_CS1(ALT14)	
				PWM0_P_0(ALT16)	
				PWM1_P_0(ALT17)	
				TRGM0_P_00(ALT18)	
				QEI0_H1(ALT20)	



	封装							
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能			
_100	_64	48						
				GPIO_A_25(ALT0)				
				GPTMR2_CAPT_1(ALT1)				
				UART6_RXD(ALT2)				
				I2C2_SDA(ALT4)				
				SPI1_CS_1(ALT5)				
86	56	43	PA25	CAN2_RXD(ALT7)	-			
				XPI0_CA_DQS(ALT14)				
				PWM0_P_1(ALT16)				
				PWM1_P_1(ALT17)				
				TRGM0_P_01(ALT18)				
				QEI0_F(ALT20)				
				GPIO_A_26(ALT0)				
					GPTMR2_COMP_2(ALT1)			
				UART6_RTS(ALT3)				
				SPI1_CS_0(ALT5)				
				LIN2_RXD(ALT6)				
				CAN2_STBY(ALT7)				
82	55	42	PA26	XPI0_CA_D_3(ALT14)	_			
02		72	17120	PWM0_P_2(ALT16)				
				PWM1_P_2(ALT17)				
				TRGM0_P_02(ALT18)				
				QEI0_A(ALT20)				
				QEO0_A(ALT21)				
				SEI0_DE(ALT22)				
				SYSCTL_CLK_OBS_0(ALT				
				24)				



	封装	ı			
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_A_27(ALT0)	
				UART6_CTS(ALT3)	
				SPI1_SCLK(ALT5)	
				LIN2_TXD(ALT6)	
				XPI0_CA_SCLK(ALT14)	
				PWM0_P_3(ALT16)	
81	54	41	PA27	PWM1_P_3(ALT17)	-
				TRGM0_P_03(ALT18)	
				QEI0_B(ALT20)	
				QEO0_B(ALT21)	
				SEI0_CK(ALT22)	
				SYSCTL_CLK_OBS_1(ALT	
				24)	
				GPIO_A_28(ALT0)	
				UART7_CTS(ALT3)	
				I2C3_SDA(ALT4)	
				SPI1_MISO(ALT5)	
				LIN2_TREN(ALT6)	
				XPI0_CA_D_0(ALT14)	
				PWM0_P_4(ALT16)	
80	53	40	PA28	PWM1_P_4(ALT17)	-
				TRGM0_P_04(ALT18)	
				RDC0_EXC_P(ALT19)	
				QEI0_Z(ALT20)	
				QEO0_Z(ALT21)	
				SEI0_TX(ALT22)	
				SYSCTL_CLK_OBS_2(ALT	
				24)	



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
			GPIO_A_29(ALT0)		
				GPTMR3_COMP_3(ALT1)	
				UART7_DE(ALT2)	
				UART7_RTS(ALT3)	
				I2C3_SCL(ALT4)	
				SPI1_MOSI(ALT5)	
				LIN3_TREN(ALT6)	
				CAN3_STBY(ALT7)	
79	52	39	PA29	XPI0_CA_D_2(ALT14)	-
				PWM0_P_5(ALT16)	
				PWM1_P_5(ALT17)	
				TRGM0_P_05(ALT18)	
				RDC0_EXC_N(ALT19)	
				QEI0_H0(ALT20)	
				SEI0_RX(ALT22)	
				SYSCTL_CLK_OBS_3(ALT	
				24)	
				USB0_OC(ALT25)	
				GPIO_A_30(ALT0)	
				UART7_RXD(ALT2)	
				SPI1_DAT2(ALT5)	
				LIN3_RXD(ALT6)	
				CAN3_RXD(ALT7)	
78	51	38	PA30	XPI0_CA_D_1(ALT14)	-
				PWM0_P_6(ALT16)	
				PWM1_P_6(ALT17)	
				TRGM0_P_06(ALT18)	
				QEI0_H1(ALT20)	
				SOC_REF0(ALT24)	
				USB0_PWR(ALT25)	



	封装									
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能					
_100	_64	48								
				GPIO_A_31(ALT0)						
				GPTMR2_COMP_3(ALT1)						
				UART7_TXD(ALT2)						
				SPI1_DAT3(ALT5)						
				LIN3_TXD(ALT6)						
77	50	37	PA31	CAN3_TXD(ALT7)	_					
• •		0,	17.01	XPI0_CA_CS0(ALT14)						
				PWM0_P_7(ALT16)						
				PWM1_P_7(ALT17)						
				TRGM0_P_07(ALT18)						
				QEI0_F(ALT20)						
				USB0_ID(ALT25)						
									GPIO_B_00(ALT0)	
				UART0_TXD(ALT2)	ADC0_IN15					
				LIN0_TXD(ALT6)	ADC1_IN15					
63	41	-	PB00	CAN0_TXD(ALT7)	ACMP_CMP0_INN					
				PWM0_P_0(ALT16)	OPA0_OUT					
				PWM1_FAULT_0(ALT17)						
				TRGM0_P_04(ALT18)						
				ACMP_COMP_0(ALT19)						
				GPIO_B_01(ALT0)						
				GPTMR1_CAPT_0(ALT1)						
				UART0_RXD(ALT2)	ADC0_IN14					
				LIN0_RXD(ALT6)	ADC1_IN14					
62	40	-	PB01	CAN0_RXD(ALT7)	ACMP_CMP1_INN					
				PWM0_P_1(ALT16)	OPA1_OUT					
				PWM1_FAULT_1(ALT17)	_					
				TRGM0_P_05(ALT18)						
				ACMP_COMP_1(ALT19)						



LQFP _100	封装 LQFP _64	QFN_ 48	PIN 名称	数字功能	模拟功能
61	-	-	PB02	GPIO_B_02(ALT0) GPTMR1_COMP_1(ALT1) UART0_DE(ALT2) UART0_RTS(ALT3) I2C0_SCL(ALT4) LIN0_TREN(ALT6) CAN0_STBY(ALT7) PWM0_P_2(ALT16) ACMP_COMP_1(ALT17) TRGM0_P_06(ALT18) PWM0_FAULT_0(ALT19)	ADC0_IN12 ADC1_IN12 ACMP_CMP0_INP7 OPA0_EXT
60	-	-	PB03	GPIO_B_03(ALT0) GPTMR1_CAPT_1(ALT1) UART0_CTS(ALT3) I2C0_SDA(ALT4) SPI2_CS_3(ALT5) CAN1_STBY(ALT7) PWM0_P_3(ALT16) ACMP_COMP_0(ALT17) TRGM0_P_07(ALT18) PWM0_FAULT_1(ALT19)	ADC0_IN8 ADC1_IN8 ACMP_CMP1_INP7 OPA1_EXT
59	-	-	PB04	GPIO_B_04(ALT0)  UART1_CTS(ALT3)  SPI3_CS_0(ALT5)  CAN1_RXD(ALT7)  PWM0_P_4(ALT16)  PWM1_P_0(ALT17)  TRGM0_P_00(ALT18)  QEI1_A(ALT20)  QEO1_A(ALT21)  SEI0_DE(ALT22)	ADC0_IN0 ADC1_IN0 ACMP_CMP0_INN5 ACMP_CMP1_INN5 OPA0_INP0



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
				GPIO_B_05(ALT0)	
				GPTMR1_COMP_2(ALT1)	
				UART1_DE(ALT2)	
				UART1_RTS(ALT3)	
				SPI3_SCLK(ALT5)	ADC0_IN13
				LIN1_TREN(ALT6)	ADC1_IN13
58	-	-	PB05	CAN1_TXD(ALT7)	ACMP_CMP0_INN3
				PWM0_P_5(ALT16)	ACMP_CMP1_INN3
				PWM1_P_1(ALT17)	OPA0_INN0
				TRGM0_P_01(ALT18)	
				QEI1_B(ALT20)	
				QEO1_B(ALT21)	
				SEI0_CK(ALT22)	
				GPIO_B_06(ALT0)	
				GPTMR0_CAPT_0(ALT1)	
				UART1_RXD(ALT2)	
				I2C1_SDA(ALT4)	
				SPI3_MISO(ALT5)	ADC0_IN9
				LIN1_TXD(ALT6)	ADC1_IN9
54	-	-	PB06	PWM0_P_6(ALT16)	ACMP_CMP0_INP5
				PWM1_P_2(ALT17)	ACMP_CMP1_INP5
				TRGM0_P_02(ALT18)	OPA0_INP1
				RDC0_EXC_P(ALT19)	
				QEI1_Z(ALT20)	
				QEO1_Z(ALT21)	
				SEI0_TX(ALT22)	
				GPIO_B_07(ALT0)	
				GPTMR0_COMP_0(ALT1)	
				UART1_TXD(ALT2)	
				I2C1_SCL(ALT4)	ADC0 IN10
				SPI3_MOSI(ALT5)	_
F 2			DB07	LIN1_RXD(ALT6)	ADC1_IN10
53	_	_	PB07	PWM0_P_7(ALT16)	ACMP_CMP0_INP3
				PWM1_P_3(ALT17)	ACMP_CMP1_INP3
				TRGM0_P_03(ALT18)	OPA0_INN1
				RDC0_EXC_N(ALT19)	
				QEI1_H0(ALT20)	
				SEI0_RX(ALT22)	



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
52	36	27	PB08	GPIO_B_08(ALT0) GPTMR0_COMP_1(ALT1) UART2_TXD(ALT2) I2C2_SCL(ALT4) SPI2_CS_2(ALT5) CAN2_TXD(ALT7) ACMP_COMP_0(ALT16) PWM1_P_4(ALT17) QEI1_H1(ALT20) QEO1_A(ALT21) SEI1_DE(ALT22) USB0_ID(ALT25)	ADC0_IN11 ADC1_IN11 DAC0_OUT ACMP_CMP0_INN0 ACMP_CMP1_INN0 OPA0_INP2 OPA1_INP2
51	35	26	PB09	GPIO_B_09(ALT0) GPTMR0_CAPT_1(ALT1) UART2_RXD(ALT2) I2C2_SDA(ALT4) SPI2_CS_1(ALT5) CAN2_RXD(ALT7) ACMP_COMP_1(ALT16) PWM1_P_5(ALT17) QEI1_F(ALT20) QEO1_B(ALT21) SEI1_CK(ALT22) USB0_OC(ALT25)	ADC0_IN1 ADC1_IN1 DAC1_OUT ACMP_CMP0_INP6 ACMP_CMP1_INP6 OPA0_INN2 OPA1_INN2
50	34	25	PB10	GPIO_B_10(ALT0) GPTMR0_COMP_2(ALT1) UART2_DE(ALT2) UART2_RTS(ALT3) SPI2_CS_0(ALT5) LIN2_RXD(ALT6) CAN2_STBY(ALT7) ACMP_COMP_0(ALT16) PWM1_P_6(ALT17) QEI0_H1(ALT20) QEO1_Z(ALT21) SEI1_TX(ALT22) USB0_PWR(ALT25)	ADC0_IN2 ADC1_IN2 ACMP_CMP0_INP4 ACMP_CMP1_INP4 OPA0_INP3 OPA1_INP3



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
49	33	24	PB11	GPIO_B_11(ALT0)	
				UART2_CTS(ALT3)	ADC0_IN3
				SPI2_SCLK(ALT5)	ADC1_IN3
				LIN2_TXD(ALT6)	ACMP_CMP0_INN4
45				ACMP_COMP_1(ALT16)	ACMP_CMP1_INN4
				PWM1_P_7(ALT17)	OPA0_INN3
				QEI0_F(ALT20)	OPA1_INN3
				SEI1_RX(ALT22)	
		32 23	PB12	GPIO_B_12(ALT0)	
				UART3_CTS(ALT3)	
				I2C3_SDA(ALT4)	
	32			SPI2_MISO(ALT5)	ADC0_IN4
				LIN2_TREN(ALT6)	ADC1_IN4
48				PWM1_FAULT_0(ALT16)	ACMP_CMP0_INN2
				PWM1_P_0(ALT17)	ACMP_CMP1_INN2
				TRGM0_P_00(ALT18)	OPA1_INP0
				QEI0_A(ALT20)	
				QEO1_A(ALT21)	
				SEI0_DE(ALT22)	
	31	31 22	PB13	GPIO_B_13(ALT0)	
				GPTMR1_COMP_3(ALT1)	
				UART3_DE(ALT2)	
47				UART3_RTS(ALT3)	
				I2C3_SCL(ALT4)	ADC0_IN5
				SPI2_MOSI(ALT5)	ADC0_IN5
				LIN3_TREN(ALT6)	ACMP_CMP0_INP2
				CAN3_STBY(ALT7)	ACMP CMP1 INP2
				PWM1_FAULT_1(ALT16)	OPA1 INN0
				PWM1_P_1(ALT17)	OFAT_IMINU
				TRGM0_P_01(ALT18)	
				QEI0_B(ALT20)	
				QEO1_B(ALT21)	
				SEI0_CK(ALT22)	



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
46	30	21	PB14	GPIO_B_14(ALT0)  UART3_RXD(ALT2)  SPI2_DAT2(ALT5)  LIN3_RXD(ALT6)  CAN3_RXD(ALT7)  PWM0_FAULT_0(ALT16)  PWM1_P_2(ALT17)  TRGM0_P_02(ALT18)  RDC0_EXC_P(ALT19)  QEI0_Z(ALT20)  QEO1_Z(ALT21)	ADC0_IN6 ADC1_IN6 ACMP_CMP0_INN ACMP_CMP1_INN OPA1_INP1
				SEI0_TX(ALT22)	
45	29	20	PB15	GPIO_B_15(ALT0) GPTMR0_COMP_3(ALT1) UART3_TXD(ALT2) SPI2_DAT3(ALT5) LIN3_TXD(ALT6) CAN3_TXD(ALT7) PWM0_FAULT_1(ALT16) PWM1_P_3(ALT17) TRGM0_P_03(ALT18) RDC0_EXC_N(ALT19) QEI0_H0(ALT20) SEI0_RX(ALT22)	ADC0_IN7 ADC1_IN7 ACMP_CMP0_INP ACMP_CMP1_INP OPA1_INN1
41	28	19	PY00	GPIO_Y_00(ALT0)  GPTMR3_COMP_0(ALT1)  UART0_TXD(ALT2)  LIN2_TXD(ALT6)  CAN2_TXD(ALT7)  PWM0_P_0(ALT16)  PWM1_P_4(ALT17)  PWM0_FAULT_0(ALT18)  USB0_ID(ALT25)	-



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
			PY01	GPIO_Y_01(ALT0)	
		18		GPTMR3_CAPT_0(ALT1)	
				UART0_RXD(ALT2)	
				LIN2_RXD(ALT6)	
40	27			CAN2_RXD(ALT7)	
40	21			PWM0_P_1(ALT16)	_
				PWM1_P_5(ALT17)	
				PWM0_FAULT_1(ALT18)	
				WDG0_RST(ALT24)	
				USB0_OC(ALT25)	
				GPIO_Y_02(ALT0)	
				GPTMR3_COMP_1(ALT1)	
			PY02	UART0_DE(ALT2)	
		6 -		UART0_RTS(ALT3)	
	26			I2C2_SCL(ALT4)	
				LIN2_TREN(ALT6)	
39				CAN2_STBY(ALT7)	-
				PWM0_P_2(ALT16)	
				PWM1_P_6(ALT17)	
				ACMP_COMP_0(ALT18)	
				PWM1_FAULT_0(ALT19)	
				WDG1_RST(ALT24)	
				USB0_PWR(ALT25)	
				GPIO_Y_03(ALT0)	
				GPTMR3_CAPT_1(ALT1)	
				UART0_CTS(ALT3)	
	25	-	PY03	I2C2_SDA(ALT4)	
38				CAN3_STBY(ALT7)	-
				PWM0_P_3(ALT16)	
				PWM1_P_7(ALT17)	
				ACMP_COMP_1(ALT18)	
				PWM1_FAULT_1(ALT19)	
	-	-	PY04	GPIO_Y_04(ALT0)	
				UART1_CTS(ALT3)	
37				SPI2_CS_0(ALT5)	_
				CAN3_RXD(ALT7)	
				PWM0_P_4(ALT16)	
				TRGM0_P_04(ALT18)	



	封装				
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
			GPIO_Y_05(ALT0)		
				GPTMR3_COMP_2(ALT1)	
				UART1_DE(ALT2)	
				UART1_RTS(ALT3)	
36			PY05	SPI2_SCLK(ALT5)	
30	-	-	F 105	LIN3_TREN(ALT6)	-
				CAN3_TXD(ALT7)	
				PWM0_P_5(ALT16)	
				TRGM0_P_05(ALT18)	
				WDG0_RST(ALT24)	
				GPIO_Y_06(ALT0)	
				GPTMR2_CAPT_0(ALT1)	
				UART1_RXD(ALT2)	
				I2C3_SDA(ALT4)	
35	-	-	PY06	SPI2_MISO(ALT5)	-
				LIN3_TXD(ALT6)	
				PWM0_P_6(ALT16)	
				TRGM0_P_06(ALT18)	
				WDG1_RST(ALT24)	
				GPIO_Y_07(ALT0)	
				GPTMR2_COMP_0(ALT1)	
				UART1_TXD(ALT2)	
34	_	_	PY07	I2C3_SCL(ALT4)	_
04	_	_	1 107	SPI2_MOSI(ALT5)	_
				LIN3_RXD(ALT6)	
				PWM0_P_7(ALT16)	
				TRGM0_P_07(ALT18)	
74	48	35	XTALI	-	-
75	49	36	XTALO	-	-
73	-	-	USB_DM	-	-
72	-	-	USB_DP	-	-
26	17	13	RESETN	-	-
27	18	14	WAKEUP	-	-
68	-	-	USBVBUS	-	-
30	21	-	DCDC_IN	-	-
28	19	-	DCDC_GND	-	-
29	20	15	DCDC_LP	-	-
21	-	-	DCDC_SNS	-	-



封装					
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能	模拟功能
_100	_64	48			
7,17,2 0,44,5 7,69,8 3,94	5,12,3 9,45,5 8	5,9,28 ,33,45	VDD_SOC	-	-
31	22	16	VPMC	-	-
23	14	10	VDD_OTPCA	-	-
33	24	17	VDD_PMCCA	- P	-
71	-	-	VPLL	-	-
67	44	32	VANA	-	-
9,15,8 5,96	7,47,6 0	6,34	VIO_B00	-	-
42,55	37	29	VIO_B01	-	-
65	43	31	VREFH	-	-
64	42	30	VREFL	-	-
8,10,1 6,22,3 2,43,5 6,66,7 0,76,8 4,95	6,13,2 3,38,4 6,59	-	VSS	-	-

表 2: SOC IOMUX

	封装					
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能		
_100	_64	48				
				PGPIO_Y_00(ALT0)		
41	28	19	PY00	PUART_TXD(ALT1)		
41	20	19	PTMR_COMP_0(ALT2			
				SOC_GPIO_Y_00(ALT3)		
				PGPIO_Y_01(ALT0)		
40	27	18	PY01	PUART_RXD(ALT1)		
40	21		10	PTUI	PTMR_COMP_1(ALT2)	
				SOC_GPIO_Y_01(ALT3)		
				PGPIO_Y_02(ALT0)		
39	26		PY02	PUART_RTS(ALT1)		
39	20	-   P102		PTMR_COMP_2(ALT2)		
				SOC_GPIO_Y_02(ALT3)		



	封装			
LQFP	LQFP	QFN_	PIN 名称	数字功能
_100	_64	48		
				PGPIO_Y_03(ALT0)
38	25		PY03	PUART_CTS(ALT1)
36	25	_	P 103	PTMR_COMP_3(ALT2)
				SOC_GPIO_Y_03(ALT3)
				PGPIO_Y_04(ALT0)
37	-	-	PY04	PTMR_COMP_0(ALT2)
				SOC_GPIO_Y_04(ALT3)
				PGPIO_Y_05(ALT0)
36			PY05	PWDG_RST(ALT1)
30	-	_	P 105	PTMR_CAPT_0(ALT2)
				SOC_GPIO_Y_05(ALT3)
				PGPIO_Y_06(ALT0)
35	-	-	PY06	PTMR_COMP_1(ALT2)
				SOC_GPIO_Y_06(ALT3)
				PGPIO_Y_07(ALT0)
34	-	-	PY07	PTMR_CAPT_1(ALT2)
				SOC_GPIO_Y_07(ALT3)

表 3: PMIC IOMUX



## 2.5 特殊功能引脚

芯片默认是通过 BOOT\_MODE[1:0]=[PA03:PA02] 引脚选择三种不同的启动模式,启动配置如表 4。其他特殊引脚配置如表 5。

启动模式	选择引脚	启动模式	说明
BOOT_MODE1	BOOT_MODE0	旧纫铁八	PE-93
0	0	XPI NOR 启动	从连接在 XPI0 上的串行 NOR
			FLASH 启动
0	1	在系统编程	从 UART0/USB0 上烧写固件,
		(ISP)/串行启动	OTP, 或从 UART0/USB0 上启动
1	0	在系统编程	从 UART0/USB0 上烧写固件,
		(ISP)/串行启动	OTP, 或从 UART0/USB0 上启动
1	1	保留模式	保留模式

表 4: 启动配置表

引脚名称	描述	建议用法
XTALI	24MHz 时钟输入	接 24MHz 晶体或有源时钟
XTALO	24MHz 时钟输出	接 24MHz 晶体或悬空

表 5: 特殊功能引脚配置

注意:本产品的LQFP64、QFN48封装上:

- USB\_DP 与 PA24 复用, 当用作 USB 功能时, 应当配置 PA24 为模拟功能 (PAD[FUNC\_CTL].ANALOG 位置 1)
- USB\_DM 与 PA25 复用, 当用作 USB 功能时, 应当配置 PA25 为模拟功能 (PAD[FUNC\_CTL].ANALOG 位置 1)
- 在系统编程(ISP)模式下,仅支持从 UARTO 烧写固件,或从 UARTO 启动

## 2.6 IO 复位状态

表 6总结了本产品所有 IO 在系统复位后的状态:

名称	复位后状态
PA04	高阻
PA05	输入内部上拉
PA06	输入内部下拉
PA07	输入内部上拉
PA08	输入内部上拉
其余 IO	输入状态保持器

表 6: IO 复位状态表



## 3 电源

该系列芯片供电是通过对 DCDC\_IN 和 VPMC 脚输入 3.0-3.6V 单一电源, 并通过内置的电压调节器提供系统 所需的 VDD\_SOC, VDD\_PMCCAP, VDD\_OTPCAP。当电源 DCDC\_IN 掉电后,通过 VPMC 脚为电源管理域和 PDGO 提供电源。每个 I/O 电源 VIO\_Bxx 根据相应负载接 3.3V 电源。

## 3.1 电源框图

## 3.2 上下电时序

上下电时序如图 5。

上电要求 VPMC 不能迟于其他电源上电即可,下电要求 VPMC 不早于其他电源下电即可。

图 5: 上电时序要求

# 4 电气特性

## 4.1 工作条件

若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。

#### 4.1.1 最大值和最小值

表 7给出了此芯片支持工作环境的最大值和最小值;超过表 7所列的值,可能会对芯片造成永久伤害。

符号	描述	最小值	最大值	单位
DCDC_IN	DCDC 输入电压	-0.3	3.6	V
VPMC	VPMC 输入电压	-0.3	3.6	V
VDD_SOC	VDD_SOC 输入电压	-0.3	1.3	V
VDD_USB	USB CORE 输入电压	-0.3	1.3	V
VANA	VANA 输入电压	-0.3	3.6	V
VREFH	ADC 参考电压	2.4	3.6	V
USB0_VBUS	USB0 输入检测电压	-	5.5	V
VUSB	USB 输入电压	-0.3	3.6	V
VIO_Bxx(3.3V 模式)	IO 对应电源 3.3V 供电	-0.3	3.6	V
VIO_Bxx(1.8V 模式)	IO 对应电源 1.8V 供电	-0.3	1.98	V
ESD HBM	HBM 模型的抗 ESD 电压	-	2000	V
ESD CDM	CDM 模型的抗 ESD 电压	-	500	V
$T_{STG}$	存储温度	-40	150	°C

表 7: 最大值和最小值



#### 4.1.2 正常工作条件

表8列出了芯片的正常工作条件,若超出此表所列的工作条件,将不保证芯片的正常功能和性能。

符号	描述	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
		处理器主	1.15	1.175	1.30	V
VDD 600	VDD 000 th ) the	频 <=480				
VDD_SOC	VDD_SOC 输入电压	MHz				
		处理器主	TBD	TBD	1.30	V
		频				
		<=TBD				
		MHz				
		休眠模	0.9	-	1.25	V
		式(1)				
DCDC_IN	DCDC 输入电压	-	3.0	3.3	3.6	V
VPMC	VPMC 输入电压	-	3.0	3.3	3.6	V
VANA	VANA 输入电压	-	3.0	3.3	3.6	V
VBUS0	VBUS0 输入电压	-	-	5.0	5.5	V
VUSB	VUSB 输入电压	-	3.0	3.3	3.6	V
VIO_Bxx (3.3V 模式)	对应 IO 电源 3.3V	-	3.0	3.3	3.6	V
VIO_Bxx (1.8V 模式)	对应 IO 电源 1.8V	-	1.62	1.8	1.98	V
$T_A$	工作环境温度	-	-40	-	105	°C
$T_J$	工作芯片结温	-	-40	-	125	°C

表 8: 正常工作条件

1. 休眠模式下,片上 DCDC 可保持较低电压输出,从而保存片上 SRAM 内的数据。

# 4.2 内置闪存特性

本产品内置 1MB 闪存。

内置的 1MB 闪存,分为 4096 个页(page),每个页包含 256 字节(Byte)。一次编程最多可以烧写 256 字节。闪存的擦除可以按照每 4 页 (1K 字节),16 页 (4K 字节),128 页 (32K 字节),256 页 (64K 字节) 和全片来进行。内置闪存的特性如表 9。

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
ICC Standby	闪存待机电流	-	7.0	35	uA
ICC DPD	闪存深度休眠电流	-	0.6	4	uA
ICC Read	闪存读取电流	-	3	13	mA
ICC P	闪存编程电流	-	1.5	4	mA
ICC 1KE	闪存 1KB 擦除电流	-	1	5	mA



符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
ICC 4KE	闪存 4KB 擦除电流	-	1	6	mA
ICC 32KE	闪存 32KB 擦除电流	-	1	7	mA
ICC 64KE	闪存 64KB 擦除电流	-	1	8	mA
ICC CE	ICC CE 闪存全擦除电流		1	9	mA
t BP	BP 闪存字节编程时间		100	200	us
t PP	闪存页编程时间	-	1	2	ms
t SE	闪存 1KB/4KB 扇区擦除时间	-	2.3	5	ms
t BE	闪存 32KB/64KB 块擦除时间	-	2.3	5	s
t CE	闪存全擦除时间	-	5	9	ms
Endurance 25°C 编程/擦除周期数		200k		-	Cycles
Data Retention	25°C 数据保存时间	-	50	-	Years

表 9: 内置闪存特性

# 4.3 VPMC 欠压检测

VPMC 欠压检测 BOR 的特性如表 10。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
欠压警告生效电压	VBOR Warning	-	2.8	-	V	-
	Assert					
欠压警告释放电压	VBOR Warning	-	2.9	-	V	-
	Release					
欠压复位生效电压	VBOR Reset	-	2.6	-	V	-
	Assert					
欠压复位释放电压	VBOR Reset	-	2.7	-	V	-
	Release					

表 10: VPMC 欠压检测特性

# 4.4 振荡器

# 4.4.1 24MHz 振荡器特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
频率	FREQ	-	24	-	MHz	-
等效串联电阻	ESR	-	40~80	-	Ω	-
负载电容	CL	-	6	-	pF	-



参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注

表 11: 24MHz 晶振

#### 4.4.2 32KHz RC 振荡器时钟特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
频率	FREQ	-	32	-	KHz	-
频率准确度 (未校准)		-10	-	10	%	-

表 12: 32KHz RC 振荡器

#### 4.4.3 24MHz RC 振荡器时钟特性

	参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
	频率	FREQ	-	24	-	MHz	-
Ī	频率准确度		-2	-	2	%	-

表 13: 24MHz RC 振荡器

#### 4.4.4 PLL 特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
参考频率	fREF	-	24	-	MHz	-
VCO 频率	fVCO	400	-	1000	MHz	-
锁定时间	tLOCK	-	-	2400	cycle	参考时钟周期

表 14: PLL 特性参数

# 4.5 外设时钟特性



## 4.6 工作模式

芯片在不同模式下的各模块电源配置如表 15

模式	CPU0 子系统电源	VDD_SOC	VPMC	DGO
等待模式	开	开	开	开
停止模式	可选	开	开	开
休眠模式	关	关	开	开
关机模式	关	关	关	开

表 15: 工作模式配置表

## 4.7 供电电流特性

电流消耗受多个参数和因素影响,其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件软件配置、工作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。

IDD(DCDC\_IN)的供电电流如表 16所示。DCDC\_IN、VPMC 由外部 3.3V 供电,VDD\_SOC 由片上 DCDC 产生。CPU 运行 CoreMark 程序,代码是从指令本地存储器(ILM)执行。外设时钟打开后均处于默认频率(详情请参考 HPM5300 用户手册)。测试都是在典型工艺参数下的芯片上测试所得,仅供参考。

IDD(VPMC)的供电电流如表 19所示。

IDD(VBAT)的供电电流如??所示,SOC处于关机模式。

符号	测试条件	CPU0	外设状态	<i>T</i> <sub>A</sub> =25°C	$T_A$ =85°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =105°C	单位
	VDD_SOC=1.175V	开	全开	59.9	64.7	67.8	mA
	CPU/BUS@480/160MHz	开	全关	33.5	36.8	39.6	mA
DCDC IN	VDD_SOC=1.10V	开	全开	36.2	39.1	41.4	mA
= 3.3V	CPU/BUS@240/120MHz	开	全关	18.3	20.7	22.8	mA
	VDD_SOC=1.10V	开	全开	28.7	31.3	33.6	mA
	CPU/BUS@100/100MHz	开	全关	13.1	15.4	17.3	mA
	VDD_SOC=1.05V	开	全开	5.5	7.3	8.8	mA
	CPU/BUS@24/24MHz	开	全关	3.2	4.8	6.4	mA

表 16: 运行模式的典型电流

符号	测试条件	工作状态	<i>T</i> <sub>A</sub> =25°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =85°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =105°C	单位
IDD PMC	VPMC = 3.3V	运行模式 DCDC ON	1.06	1.14	1.20	mA
IDD PMC	VPMC = 3.3V	休眠模式 DCDC OFF	0.53	0.59	0.64	mA
IDD PMC	VPMC = 3.3V	关机模式 DGO Only	2.3	3.1	4.8	uA

表 17: IDD(VPMC) 典型电流



符号	测试条件	工作状态	<i>T</i> <sub>A</sub> =25°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =85°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =105°C	单位
IDD VANA	VANA = 3.3V	ADC0 10KSPS	0.17	0.18	0.19	mA
IDD VANA	VANA = 3.3V	ALL Analog OFF	0.09	0.10	0.10	mA

表 18: IDD(VANA) 典型电流

符号	测试条件	工作状态	<i>T</i> <sub>A</sub> =25°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =85°C	<i>T</i> <sub>A</sub> =105°C	单位
IDD VPLL	VPLL = 3.3V	ALL PLL ON	2.55	2.64	2.67	mA
IDD VPLL	VPLL = 3.3V	PLL0 ON	1.75	1.79	1.81	mA
IDD VPLL	VPPL = 3.3V	ALL PLL OFF	0.83	0.83	0.84	mA

表 19: IDD(VPLL) 典型电流

# 4.8 I/O 特性

## 4.8.1 I/O DC 特性

I/O 特性如表 20。

符号	参数	最小	典型	最大	单位
VDDIO 1.8V	IO 电源	1.62	1.8	1.98	V
VDDIO 3.3V	IO 电源	2.97	3.3	3.63	V
VIL 1.8V	输入低电平	0	-	0.3*VDDIO	V
VIH 1.8V	输入高电平	0.7*VDDIO	-	VDDIO	V
VOL 1.8V	输出低电平	-		0.15	V
VOH 1.8V	输出高电平	VDDIO-0.15	-	-	V
VIL 3.3V	输入低电平	0	-	0.3*VDDIO	V
VIH 3.3V	输入高电平	0.7*VDDIO	-	VDDIO	V
VOL 3.3V	输出低电平	-	-	0.15	V
VOH 3.3V	输出高电平	VDDIO-0.15	-	-	V
RPU22K	上拉电阻	17.1	22	28.3	kΩ
RPU47K	上拉电阻	36	47	60	kΩ
RPU100K	上拉电阻	75	100	125	kΩ
RPD100K	下拉电阻	75	100	125	kΩ

表 20: IO 工作条件



# 4.8.2 I/O AC 特性

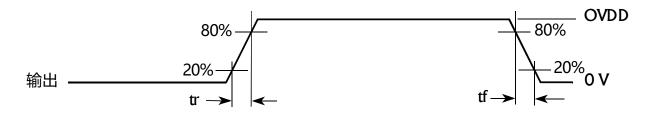


图 6: I/O AC 特性

类型	参数	符号	最小	最大	单位	测试条件
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tr/tf	-	4.4/4.3	ns	15pf 负载,fast slew rate,驱动
1.8V						强度 111b
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tf/tf	-	8.2/7.9	ns	15pf 负载,slow slew rate,驱动
1.8V						强度 111b
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tr/tf	-	4.6/4.4	ns	15pf 负载,fast slew rate,驱动
1.8V						强度 <b>011b</b>
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tf/tf	-	8.6/8.3	ns	15pf 负载,slow slew rate,驱动
1.8V						强度 <b>011b</b>
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tr/tf	-	2.6/2.5	ns	15pf 负载,fast slew rate,驱动
3.3V						强度 111b
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tf/tf	-	4.3/4.2	ns	15pf 负载,slow slew rate,驱动
3.3V						强度 111b
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tr/tf	-	2.9/2.7	ns	15pf 负载,fast slew rate,驱动
3.3V						强度 011b
3.3/1.8V IO	上升/下降时间	tf/tf	-	4.5/4.4	ns	15pf 负载,slow slew rate,驱动
3.3V						强度 011b
3.3V IO 3.3V	上升/下降时间	tr/tf	-	2.1/1.6	ns	15pf 负载,fast slew rate,驱动
						强度 111b
3.3V IO 3.3V	上升/下降时间	tf/tf	-	3.4/3.3	ns	15pf 负载,slow slew rate,驱动
						强度 111b
3.3V IO 3.3V	上升/下降时间	tr/tf	-	2.2/1.7	ns	15pf 负载,fast slew rate,驱动
						强度 011b
3.3V IO 3.3V	上升/下降时间	tf/tf	-	3.6/3.4	ns	15pf 负载,slow slew rate,驱动
						强度 <b>011b</b>

表 21: I/O AC 特性



# 4.9 JTAG 接口

JTAG 时序如图 7。

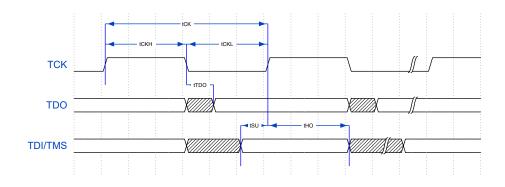


图 7: JTAG 时序图

符号	描述	最小值	最大值	单位
tCK	一个时钟周期持续的时间	40	-	ns
tCKH	一个时钟周期内高电平持续时间	0.48*P	0.52*P	ns
tCKL	一个时钟周期内低电平持续时间	0.48*P	0.52*P	ns
tSU(TDI-TCK)	输入建立时间,从 TCK 高到 TDI 有效	8	-	ns
tSU(TMS-TCK)	输入建立时间,从 TCK 高到 TMS 有效	8	-	ns
tHO(TCK-TDI)	输入保持时间,从 TCK 高到 TDI 有效	15	-	ns
tHO(TCK-TMS)	输入保持时间,从 TCK 高到 TMS 有效	15	-	ns
tTDO(TCK-TDO)	TCK 下降沿到 TDO 数据有效时间	-	15	ns

表 22: JTAG 时序参数



#### 4.10 XPI 存储器接口

#### 4.10.1 DC 特性

参考 I/O 即可

#### 4.10.2 AC 特性

XPI 采样时钟有三种源:

- 由 XPI 控制器生成并在内部回送 (XPI GCR0[RXCLKSRC] = 0x0)
- 由 XPI 控制器生成并通过 DQS 回送 (XPI GCR0[RXCLKSRC] = 0x1)
- 来自外部 DQS 的输入 (XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0x3)

以下是三种采样时钟源以及 SDR、DDR 模式对应的输入读操作的特性和时序。测量数据基于电容负载为 15pF,输入 slew rate 为 1V/ns。

#### 4.10.2.1 SDR 模式

XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1 对应时序如图 8。

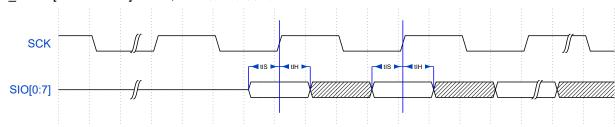


图 8: XPI SDR 模式的输入时序(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率	_	60	MHz
tIS	输入数据的建立时间	8.67	_	ns
tIH	输入数据的保持时间	0	_	ns

表 23: XPI SDR 模式的输入特性(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率		133	MHz
tIS	输入数据的建立时间	2	_	ns
tIH	输入数据的保持时间	1	_	ns

表 24: XPI SDR 模式的输入特性 (XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1)

图 8所示时序基于存储器在 SCK 下降沿生成读取数据,以及 XPI 控制器在下降沿采样读取数据。 在 SDR 模式下,XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3,由存储器提供读数据和读选通时,有两种情况:

• 情形 1: 存储器在 SCK 上升沿(或下降沿)上生成读数据和读选通信号。



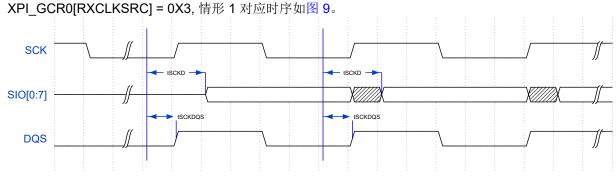


图 9: XPI SDR 模式的输入时序(XPI GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 1)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率	_	166	MHz
tSCKD - tSCKDQS	tSCKD 和 tSCKDQS 时差	-2	2	ns

表 25: XPI SDR 模式的输入特性(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3,情形 1)

图 9所示时序基于存储器在 SCK 上升沿生成读数据和读选通, XPI 控制器在 DQS 下降沿采样读取数据。

● 情形 2: 存储器在 SCK 下降沿产生读数据,在 SCK 上升沿产生读选通。

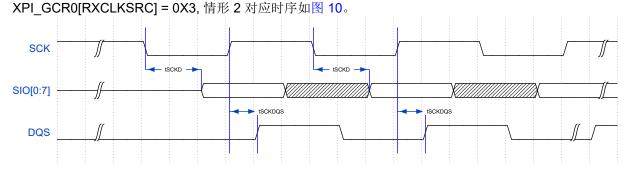


图 10: XPI SDR 模式的输入时序(XPI GCR0[RXCLKSRC] = 0X3, 情形 2)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率	_	166	MHz
tSCKD - tSCKDQS	tSCKD 和 tSCKDQS 时差	-2	2	ns

表 26: XPI SDR 模式的输入特性(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3,情形 2)

图 10是存储器在 SCK 下降沿生成读取数据并在 SCK 上升沿生成读取选通, XPI 控制器在半周期延迟的 DQS 下降沿上采样读取数据。

#### 4.10.2.2 DDR 模式

XPI DDR 模式的输入时序(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1)对应时序如图 11。



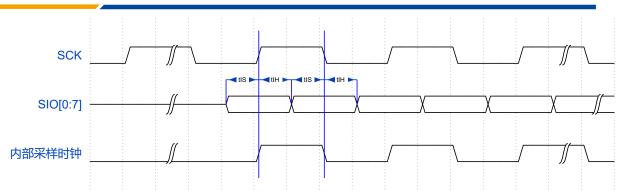


图 11: XPI DDR 模式的输入时序(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0,0X1)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率	_	30	MHz
tIS	输入数据的建立时间	8.67	_	ns
tlH	输入数据的保持时间	0	_	ns

表 27: XPI DDR 模式的输入特性(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率	_	66	MHz
tIS	输入数据的建立时间	2	_	ns
tlH	输入数据的保持时间	1	_	ns

表 28: XPI DDR 模式的输入特性(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X1)

在 DDR 模式下,XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3,存储器在 SCK 上升沿(或下降沿)上生成读数据和读选通信号。

XPI DDR 模式的输入时序(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3)对应时序如图 12。

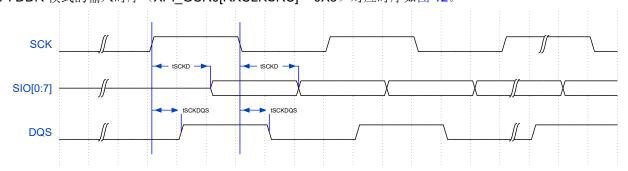


图 12: XPI DDR 模式的输入时序(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3)

符号	参数	最小值	最大值	单位
	时钟频率	_	166	MHz
tSCKD - tSCKDQS	tSCKD 和 tSCKDQS 时差	-1	1	ns

表 29: XPI DDR 模式的输入特性(XPI\_GCR0[RXCLKSRC] = 0X3

#### 4.10.2.3 XPI 输出/写操作

以下部分描述了 XPI 控制器的输出信号时序,包括控制信号和数据输出。

#### ● SDR 模式

XPI SDR 模式的输出信号时序对应时序如图 13。

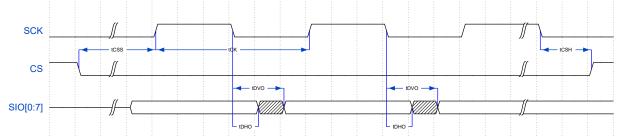


图 13: XPI SDR 模式的输出信号

符号	参数	最小值	最大值	单位
fCK	时钟频率	_	166	MHz
tCK	SCK 时钟周期	6	_	ns
tDVO	输出信号有效时间	_	1	ns
tDHO	输出信号保持时间	1	_	ns
tCSS	片选信号建立时间	3 x tCK - 1	_	ns
tCSH	片选信号保持时间	3 x tCK + 2	_	ns

表 30: XPI SDR 模式的输出信号时序

#### • DDR 模式

XPI DDR 模式的输出信号时序对应时序如图 14。

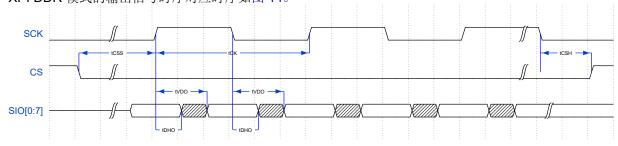


图 14: XPI DDR 模式的输出信号



# **HPM5300 系列** 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

符号	参数	Min	Max	Unit
fCK	时钟频率	_	166	MHz
tCK	SCK 时钟周期	6	_	ns
	(XPI_GCR0[RXCLKSRC] = 0X0)			
tDVO	输出信号有效时间	_	2.2	ns
tDHO	输出信号保持时间	0.8	_	ns
tCSS	片选信号建立时间	3 x tCK/2 - 0.7	1	ns
tCSH	片选信号保持时间	3 x tCK/2 + 0.8	_	ns

表 31: XPI DDR 模式的输出信号时序



# 4.11 模拟接口

# 4.11.1 16 位模数转换 ADC 特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
电源电压	VDDA	3	3.3	3.6	V	-
输入信号电压	Vin	VREFL	-	VREFH	V	-
输入采样电容	Cs	-	4	-	pF	-
采样开关电阻	Ron	-	300	-	ohm	-
参考高电平	VREFH	2.4	-	VDDA	V	-
参考低电平	VREFL	0	-	-	V	-
采样速率	fs	-	2	-	MHz	-
差分非线性	DNL	-	+1/-0.89	-	LSB	单端信号
积分非线性	INL	-	+3.1/-5.2	-	LSB	单端信号
偏移误差	Vos	-	4	-	LSB	单端信号输入接
						地
增益误差 (全摆	GE	-	3	-	LSB	单端信号输入接
幅误差)						VREFH
总未调整误差	TUE	-	7.2	-	-	单端信号
信号噪声失真比	SINAD	-	70	-	dB	单端信号
						(VREFH=3.0V)
有效位数	ENOB	-	11.3	-	位	单端信号
						(VREFH=3.0V)
总谐波失真	THD	-	93	-	dB	单端信号

表 32: 16 位 ADC 参数



# 4.11.2 比较器 ACMP 特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注	
电源电压	VDDA	3	3.3	3.6	V	-	
输入信号电平	Vin	0	-	VDDA	V	-	
输入偏移	Vos	-3	-	3	mV	HPMODE=1	
相八八冊7夕	VOS	-6	-	6	mV	HPMODE=0	
		18	24	30	mV	HPMODE=0;	
						HYST<1:0>=00	
		12	16	20	mV	HPMODE=0;	
   迟滞电压	Vhyst					HYST<1:0>=01	
之	VIIIySt	VilySt	6	8	10	mV	HPMODE=0;
						HYST<1:0>=10	
		0	0	0	mV	HPMODE=0;	
						HYST<1:0>=11	
		24	30	36	mV	HPMODE=1;	
						HYST<1:0>=00	
		16	20	24	mV	HPMODE=1;HYST<1:0>=01	
		8	10	12	mV	HPMODE=1;HYST<1:0>=10	
		0	0	0	mV	HPMODE=1;HYST<1:0>=11	
传输延迟	Tn	60	80	100	ns	HPMODE=0	
1々 棚	Тр	5	6.5	8.5	ns	HPMODE=1	

表 33: 比较器参数

## 4.11.3 12 位数模转换器 DAC 特性

符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位	
VDDA	供电电压	3.0	3.3	3.6	V	
VDACR	参考电压	1.71	3.6	3.6	V	
CLD	输出负载电容	-	-	400	pF	
RLD	输出负载电阻	3k	-	-	ohm	
IDDA	DAC LP 模式供电电流,无负载		360		uA	
DACLP	DAG LF 模式换电电视,尤页软	- 300		-	uA	
IDDA	DAC HP 模式供电电流,无负载		1.6		mA	
DACHP	DACTIF 侯八侠电电视,尤贝轼	-	1.0	-	IIIA	
Tpwrup	DAC 上电到输出有效的时间	-	-	10	uA	
	DAC HP 模式的输出建立时间					
Tdachp	RLD = $3K$ ohm, CLD = $400$ pF	-	1	1.2	uS	
	数字编码 410~3891					



符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位
	DAC LP 模式的输出建立时间				
Tdaclp	RLD = 3K ohm, CLD = 400 pF	-	3.5	4	uS
	数字编码 410~3891				
	DAC HP 模式 Slew Rate				
SRHP	RLD = 3K ohm,CLD = 400 pF	-	3	-	V/us
	数字编码 410~3891				
	DAC LP 模式 Slew Rate				
SRLP	RLD = 3K ohm, CLD = 400 pF	-	7.2	-	V/us
	数字编码 410~3891				
INL	积分非线性	-	±3	-	LSB
DNL	差分非线性	-	±0.8	-	LSB
voffoot	偏置误差		. 6		m)/
voffset	数字编码 410~3891	-	±6	-	mV
Egain	增益误差	-	±0.5	-	%
Vout	输出电压范围	VSSA+0.04	i	VDDA-	V
vout	加山电压化固	V 33A+0.04	• -	0.04	V

表 34: 12 位 DAC 参数

## 4.11.4 运算放大器 OPAMP 特性

符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	供电电压	3.0	3.3	3.6	V
CMIR	共模输入范围	0	-	VDDA	V
Vloffset	Input Offset Voltage			±2	mV
Violiset	Vcm = VDDA/2, all temprature,no load	_	-	±2	IIIV
	Input Offset Voltage				
Vloffset	All common mode input range, all	-	-	±3	mV
	temprature,no load				
lload	Drive Current, source or sink current			3300	uA
lloau	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV	_	-		uA
Rload	Resistive Load	1k	-	-	ohm
Cload	Capacitive Load	1	-	-	pF
CMRR	共模抑制比	-	76	-	dB
	电源抑制比				
PSRR	1KHz, Cload = 50pF,	02	87		٩D
FORK	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV	83	01	_	dB
	Follower Configuration				



符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位	
	电源抑制比					
PSRR	1KHz, Cload = 50pF,	55	55 77	_	dB	
TORK	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV			_	ub l	
	Non-inv amplify Configuration					
	电源抑制比					
PSRR	1KHz, Cload = 50pF,	50	78	_	dB	
ronn	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV		7.0		QD	
	Inv amplify Configuration					
	Gain bandwidth product					
	Cload≤50pF,					
GBW	No Rload or Rload≥1Kohm	3	10	16	MHz	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Follower Configuration					
	Gain bandwidth product					
	Cload≤5pF,			43		
GBW	No Rload or Rload≥1Kohm	7	27		MHz	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Follower Configuration					
	Slew Rate		7			
SR	From 10% to 90% Output voltage,	_		-	V/us	
	Cload≤50pF					
	Follower Configuration					
	Slew Rate			18 -		
SR	From 10% to 90% Output voltage,	_	18		V/us	
	Cload≤5pF					
	Follower Configuration					
	Open Loop Gain					
AO	No Rload,	92	115	118	dB	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
4.0	Open Loop Gain	00	445	440	ID.	
AO	Rloadge1Kohm,	92	115	118	dB	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Phase Margin					
DN4	Cload≤50pF,		70	70		
PM	No Rload or Rload≥1Kohm	-	/6	76 -	0	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Follower Configuration					



Phase Margin Cload≤5pF, No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤50pF, No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF, PM No Rload or Rload≥1Kohm Cload≤5pF, PM No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat  Vohsat  High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV  Volsat  Low Saturation Output Voltage  Twakeup  Wake up time from disable state  Twakeup  Wake up time from disable state  Twakeup  Cload≤5pF, Rload≥1Kohm Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup  Cload≤5pF, Rload≥1Kohm Follower Configuration  Value  Twakeup  Cload≤5pF, Rload≥1Kohm Follower Configuration  Follower Configuration  Value  Tush Afore Action  Action  To AdB  To	符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位
PM         No Rload or Rload≥1Kohm         -         66         -         ∘           250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration         -         66         -         ∘           Gain Margin Cload≤50pF,         -         16         -         dB           250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration         -         16         -         dB           PM         No Rload or Rload≥1Kohm Cload≤5pF, No Rload or Rload≥1Kohm         -         11         -         dB           250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration         VDDA- 150mV         -         -         mV           Volsat         Low Saturation Output Voltage         -         -         150         mV           Volsat         Low Saturation Output Voltage         -         -         150         mV           Wake up time from disable state         -         1.7         2.8         us           Twakeup         Cload≤5pF, Rload≥1Kohm         -         1.5         3.2         us		Phase Margin				
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤50pF,  GM No Rload or Rload≥1Kohm - 16 - dB 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF, PM No Rload or Rload≥1Kohm - 11 - dB 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV mV  Volsat Low Saturation Output Voltage 150 mV  Wake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.7 2.8 us Follower Configuration  Wake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us		Cload≤5pF,				
Follower Configuration  Gain Margin Cload≤50pF,  No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF,  PM No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV  Volsat Low Saturation Output Voltage  Wake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state	PM	No Rload or Rload≥1Kohm	-	66	-	0
Gain Margin Cload≤50pF,  GM No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF,  PM No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV  Volsat Low Saturation Output Voltage  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  VDDA- 150mV  Todad≤5pF, Rload≥1Kohm  Todad≤5pF, Rload≥1Koh		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Cload≤50pF, No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF, PM No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV  Volsat Low Saturation Output Voltage  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm Follower Configuration  Vake up time from disable state Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm		Follower Configuration				
GM       No Rload or Rload≥1Kohm       -       16       -       dB         250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration       Gain Margin Cload≤5pF,       -       11       -       dB         PM       No Rload or Rload≥1Kohm 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration       -       11       -       dB         Vohsat       High Saturation Output Voltage       VDDA- 150mV       -       -       mV         Volsat       Low Saturation Output Voltage       -       -       150       mV         Wake up time from disable state       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.7       2.8       us         Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us         Twakeup       Cload≤5pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us		Gain Margin				
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF,  PM No Rload or Rload≥1Kohm - 11 - dB 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage VDDA- 150mV  Volsat Low Saturation Output Voltage 150 mV  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm - 1.7 2.8 us Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us		Cload≤50pF,				
Follower Configuration  Gain Margin Cload≤5pF,  PM No Rload or Rload≥1Kohm - 11 - dB 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV  Volsat Low Saturation Output Voltage 150 mV  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm - 1.7 2.8 us Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us	GM	No Rload or Rload≥1Kohm	-	16	_	dB
Gain Margin Cload≤5pF,  PM No Rload or Rload≥1Kohm - 11 - dB 250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  VDDA- 150mV mV  Volsat Low Saturation Output Voltage 150 mV  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm - 1.7 2.8 us Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Cload≤5pF,         PM       No Rload or Rload≥1Kohm       -       11       -       dB         250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration       VDDA-150mV       -       -       mV         Vohsat       High Saturation Output Voltage       -       -       -       mV         Volsat       Low Saturation Output Voltage       -       -       150       mV         Wake up time from disable state       -       1.7       2.8       us         Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us         Twakeup       Cload≤5pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us		Follower Configuration				
PM       No Rload or Rload≥1Kohm       -       11       -       dB         250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV       Follower Configuration       VDDA-150mV       -       -       mV         Vohsat       High Saturation Output Voltage       -       -       -       mV         Volsat       Low Saturation Output Voltage       -       -       150       mV         Wake up time from disable state       -       1.7       2.8       us         Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us         Twakeup       Cload≤5pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us		Gain Margin				
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage  Volsat Low Saturation Output Voltage  Volsat Low Saturation Output Voltage  Voltage  VDDA- 150mV  mV  Volsat Low Saturation Output Voltage  Voltage  VDDA- 150mV  - 150 mV  Vake up time from disable state  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Vake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm  Voltage  150 mV  1.7 2.8 us		Cload≤5pF,				
Follower Configuration  Vohsat High Saturation Output Voltage VDDA- 150mV mV  Volsat Low Saturation Output Voltage 150 mV  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm - 1.7 2.8 us  Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us	PM	No Rload or Rload≥1Kohm	-	11	-	dB
Vohsat       High Saturation Output Voltage       VDDA-150mV       -       -       mV         Volsat       Low Saturation Output Voltage       -       -       150       mV         Wake up time from disable state       -       1.7       2.8       us         Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.7       2.8       us         Wake up time from disable state       -       1.5       3.2       us		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Vohsat       High Saturation Output Voltage       -       -       mV         Volsat       Low Saturation Output Voltage       -       -       150       mV         Wake up time from disable state       -       1.7       2.8       us         Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.7       2.8       us         Wake up time from disable state       -       1.5       3.2       us		Follower Configuration				
Volsat       Low Saturation Output Voltage       -       -       150 mV         Wake up time from disable state       -       1.7       2.8       us         Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.7       2.8       us         Follower Configuration       Wake up time from disable state       -       1.5       3.2       us         Twakeup       Cload≤5pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us	\/ \.		VDDA-			
Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤50pF, Rload≥1Kohm - 1.7 2.8 us  Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us	vonsat	High Saturation Output Voltage	150mV	-	-	mv
Twakeup       Cload≤50pF, Rload≥1Kohm       -       1.7       2.8       us         Follower Configuration         Wake up time from disable state         Twakeup       Cload≤5pF, Rload≥1Kohm       -       1.5       3.2       us	Volsat	Low Saturation Output Voltage	-	-	150	mV
Follower Configuration  Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us		Wake up time from disable state				
Wake up time from disable state  Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us	Twakeup	Cload≤50pF, Rload≥1Kohm	-	1.7	2.8	us
Twakeup Cload≤5pF, Rload≥1Kohm - 1.5 3.2 us		Follower Configuration				
		Wake up time from disable state				
Follower Configuration	Twakeup	Cload≤5pF, Rload≥1Kohm	-	1.5	3.2	us
		Follower Configuration				
Gain Error		Gain Error				
Gerr PGA Gain = 2, 0 - 0.5 %	Gerr	PGA Gain = 2,	0	-	0.5	%
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Gain Error		Gain Error				
Gerr PGA Gain = 4, -0.3 - 0.2 %	Gerr	PGA Gain = 4,	-0.3	-	0.2	%
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Gain Error		Gain Error				
Gerr PGA Gain = 8, -0.9 - 0.1 %	Gerr	PGA Gain = 8,	-0.9	-	0.1	%
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Gain Error		Gain Error				
Gerr PGA Gain = 16, -2.2 - 0 %	Gerr	PGA Gain = 16,	-2.2	-	0	%
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				
Gain Error						
Gerr PGA Gain = 32, -5.3 - 0 %	Gerr	PGA Gain = 32,	-5.3	-	0	%
250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV		250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV				



符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位	
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = 64,	-7.2	-	0	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = 128,	-10.3	-	0	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = -2,	-0.9	-	0	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = -4,	-0.9	-	0	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = -8,	-1	-	0	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = -16,	-1.2	-	0.3	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = -32,	-1.7	-	0.8	%	
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error					
Gerr	PGA Gain = -64,	-3	-	-	1.8	%
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	Gain Error			- 3.7	%	
Gerr	PGA Gain = -128,	-5.8	-			
	250mV≤output Voltage≤VDDA-250mV					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	10/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 2					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	30/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 4					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	70/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 8					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	150/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 16					



符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位	
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	310/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 32					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	630/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 64					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	non-inverting configuration,	-	1270/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = 128					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	20/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -2					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	40/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -4					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	80/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -8					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	160/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -16					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	320/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -32					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	640/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -64					
	PGA R2/R1 resistor value,					
Rpga	inverting configuration,	-	1280/10	-	Kohm/Kohm	
	PGA gain = -128					
Delta R	Resisitor Variation	-5	-	5	%	
	PGA Bandwith,					
PGA BW	non-inverting configuration,	-	GBW/gain	-	MHz	
	PGA gain = 2∼128					
	PGA Bandwith,		CB/M//			
PGA BW	inverting configuration,	-	GBW/(	-	MHz	
	PGA gain = -2~-128		gain   +1)			
Ndensity	Voltage Noise Density				p\// -\/II-	
indensity	1KHz, Rload = 1Kohm	_	55	-	$\text{nV}/\sqrt{Hz}$	



# **HPM5300 系列** 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

符号	描述/条件	最小值	典型值	最大值	单位
Ndensity	nsity Voltage Noise Density  10KHz, Rload = 1Kohm		22	-	$\text{nV}/\sqrt{Hz}$
IDD	OPAMP 功耗电流 No Rload,Follower Configuration	-	810	-	uA

表 35: OPAMP 参数



# 4.12 SPI 接口

#### 4.12.1 SPI 主模式时序图

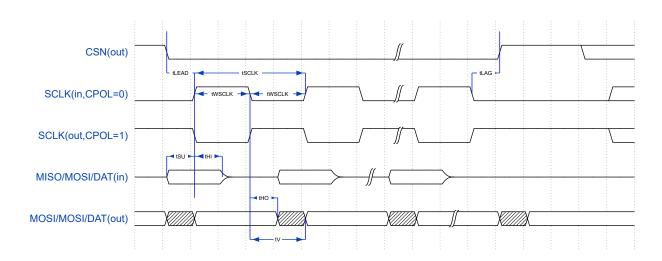


图 15: SPI 主模式时序(CPHA=0)

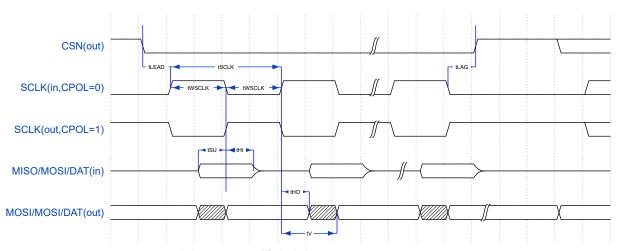


图 16: SPI 主模式时序(CPHA=1)

符号	描述	最小	最大	单位
tSCK	SCK 周期	12.5	_	ns
tLEDA	CS 建立时间	1	_	tperiph
tLAG	CS 保持时间	1	_	tperiph
tWSCK	时钟高或低时间	tSCK / 2 - 3	_	ns
tSU	数据建立时间 (输入)	10	_	ns
tHI	数据保持时间 (输入)	2	_	ns
tV	数据有效(SCLK 延后)	_	8	ns



符号	描述	最小	最大	单位
tHO	数据保持时间(输出)	0	_	ns

表 36: SPI 主模式参数 (注: tperiph = 1000 / fperiph)

#### 4.12.2 SPI 从模式时序图

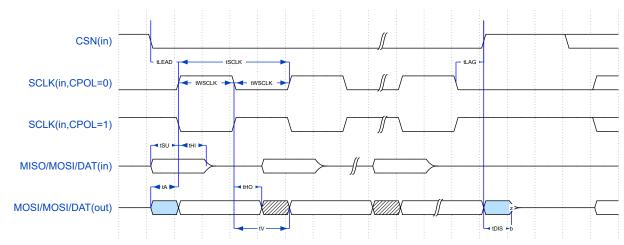


图 17: SPI 从模式时序(CPHA=0)

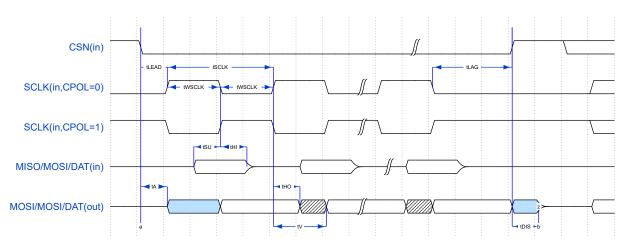


图 18: SPI 从模式时序(CPHA=1)

符号	描述	最小	最大	单位
tSCK	SCK 周期	4 x tperiph	_	ns
tLEAD	CS 建立时间	1	_	tperiph
tLAG	CS 保持时间	1	_	tperiph
tWSCK	时钟高或低时间	tSCK / 2 - 5	_	ns
tSU	数据建立时间(输入)	2.7	_	ns
tHI	数据保持时间(输入)	3.8	_	ns
tA	从访问时间	_	tperiph	ns
tDIS	从 MISO 失效时间	_	tperiph	ns



# 基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

符号	描述	最小	最大	单位
tV	数据有效(SCLK 延后)	_	14.5	ns
tHO	数据保持时间(输出)	0	_	ns

表 37: SPI 从模式参数 (注: tperiph = 1000 / fperiph)

# 4.13 I2C 接口

符号	描述	工作模式	最小值	最大值	单位
		标准模式 (Sm)	0	100	KHz
fSCL	   SCL 时钟频率	快速模式 (Fm)	0	400	KHz
ISOL SOL	JOL 时 打灰空	快速模式加 (Fm+)	0	1000	KHz

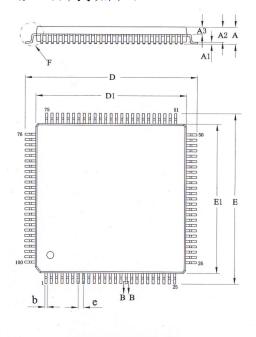
表 38: I2C 工作模式及参数

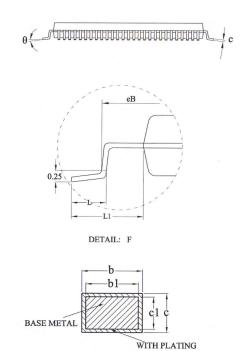


# 5 封装

# 5.1 LQFP100 封装尺寸

LQFP100 尺寸如图 19。





SECTION B-B

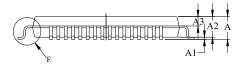
SYMBOL	MILLIMETER			
SIMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	_	_	1.60	
A1	0.05	_	0.15	
A2	1.35	1.40	1.45	
A3	0.59	0.64	0.69	
b	0.18		0.26	
b1	0.17	0.20	0.23	
С	0.13	_	0.17	
c1	0.12	0.13	0.14	
D	15.80	16.00	16.20	
D1	13.90	14.00	14.10	
Е	15.80	16.00	16.20	
E1	13.90	14.00	14.10	
eB	15.05	_	15.35	
e	0.50BSC			
L	0.45	_	0.75	
L1	1.00REF			
θ	0		7°	

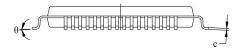
图 19: LQFP100 封装尺寸图

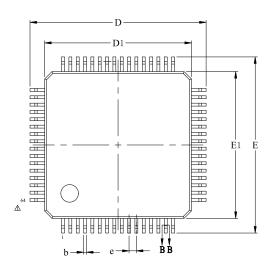


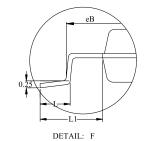
# 5.2 LQFP64 封装尺寸

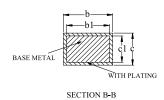
LQFP64 尺寸如??。











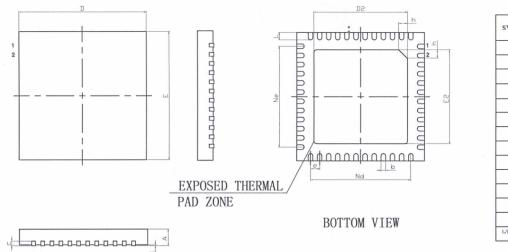
MILLIMETER SYMBOL NOM MAX A 1.60 **A**1 0.05 0.15 A2 1.35 1.40 1.45 A3 0.59 0.64 0.69 0.26 b 0.18 0.17 0.20 0.23 b1 0.13 0.17 c1 0.12 0.14 D 11.80 12.00 12.20 D1 9.90 10.00 10.10 11.80 12.20 Е 12.00 9.90 10.00 10.10 E1 0.50BSC e eB11.05 11.25 L 0.45 0.75 L1 1.00REF θ 7°

图 20: LQFP64 封装尺寸图



## 5.3 QFN48 封装尺寸

QFN48 尺寸如图 21。



MILLIMETER SYMBOL NOM MAX MIN 0.70 0.75 0.80 A1 0.02 0.15 0.20 0.25 0.23 0.20 D 6.00 6.10 4.20 4.30 2 0.40BSC 4. 40BSC Ne Nd 4. 40BSC E 5.90 6.00 6.10 E2 2 4.30 177\*177

图 21: QFN48 封装尺寸图

# 5.4 封装热阻系数

 $T_J \max = T_A \max + (P_D \max x \theta_{JA})$ 

- $T_A$  指芯片工作时的环境温度, 单位是 °C;
- $\theta_{JA}$  是指封装对工作环境的热阻系数, 单位是 °C/W;
- $P_D$  是指芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和, 单位是 W;
- T<sub>J</sub> 是指芯片表面的结温。

芯片在指定环境温度下工作时芯片内部的结温  $T_J$ ,不可以超出芯片可容许的最大结温  $T_J$  max 即可。

符号	参数	值	单位
$ heta_{JA}$	LQFP100 14X14 mm/0.5mm 间距	50+/-5%	°C/W
$\theta_{JA}$	LQFP64 10X10 mm/0.5mm 间距	47+/-5%	°C/W
$\theta_{JA}$	QFN48 6X6 mm/0.5mm 间距	29+/-5%	°C/W

表 39: 各封装热阻系数表



# 6 订购信息

# 6.1 产品命名规则

产品命名规则如图 22

# HPM5361ICB1



图 22: 产品命名规则

## 6.2 订购信息

订购信息如表 40:

产品型号	HPM5361	HPM5331	HPM5321	HPM5301
CPU		RV32-IN	MAFDCP	
主频 MHz	480	480	480	360
片上总内存		288	KB	
片上闪存		1 1	МВ	
ROM	128 KB		KB	
OTP	4096 位			



产品型号	HPM5361	HPM5331	HPM5321	HPM5301
SDP		AES-128/256,SHA-256	5	1
EXIP	X	PI0: EXIP AES-128 CT	R	1
RNG		真随机数发生器		1
安全启动		加密启动、可信启动		1
UID		128	3 位	
USB		1 个, 集成	HS PHY	
CAN-FD	4	1	4	1
LIN	4	1	4	1
UART	9	5	9	5
SPI	4	4	4	2
I2C	4	2	4	2
PWM	2x	8CH	1	1
QEIV2	2	2	1	1
QEO	2	2	1	1
SEI	2	2	1	1
MMC	2	2	1	1
RDC	1	1	1	1
PLB	1	1	1	1
TMR		5		3
WDG	3			
DMA	HDMA 32CH			
ADC		2× 16b		1× 16b
DAC	2× 12b /		1	
CMP	2			
OPAMP	2	2	1	1
GPIO	56(HPM53XXICB1),36(HPM53XXICF1),29(HPM53XXIEG1)		(XIEG1)	
		12*12 LQFP100 P0	.5 (HPM53XXICB1)	
封装	10*10 LQFP64 P0.5 (HPM53XXICF1)			
	6*6 QFN48 P0.4 (HPM53XXIEG1)			
温度范围 $T_A$	-40∼105 °C			

表 40: 订购信息

# 6.3 封装引出功能差异

本产品不同封装引出功能差异如表 41。

HPM53xxxCBx HPM53xxxCFx HPM53xxIE0	ix
------------------------------------	----



	HPM53xxxCBx	HPM53xxxCFx	HPM53xxIEGx
	LQFP100	LQFP64	QFN48
封装	14mm×14mm	10mm×10mm	6mm×6mm
	p0.5mm	p0.5mm	p0.4mm
GPIO	56	36	29
模拟功能引	16	10	8
脚	10	10	0
BOOT ROM	USB/UART0	UART0	UART0
ISP	USB/UARTU	UARTO	UARTU
内部			
IRC24M 启	不支持	支持	支持
动			

表 41: 封装引出功能差异



#### 版本信息 7

日期	版本	描述
Rev0.0	2023/05/12	内部版 Rev0.0 发布。
Rev0.1	2023/05/19	内部版 Rev0.1 发布。
		调整产品型号信息。
		更新简介章节信息。
		更新系统框图。
Rev0.2	2023/06/25	内部版 Rev0.2 发布。
		调整封面产品特征信息。
		更新简介章节信息。
		更新 IO 复位状态表格。
		更新 IDD 电流特性表格。
		更新产品选型表格。
Rev0.3	2023/07/28	内部版 Rev0.3 发布。
		更新简介章节信息。
		增加 OPAMP 特性表格。
		更新 ballmap 示意图。
		更新内置闪存特性。
Rev0.4	2023/08/15	内部版 Rev0.4 发布。
		更新产品型号信息。
		更新产品订购信息表格。
		更新功耗电流数据。

表 42: 版本信息



基于 RISC-V 内核的 32 位高性能微控制器数据手册 Rev0.4

# 8 免责声明

上海先楫半导体科技有限公司(以下简称:"先楫")保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利, 恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 https://www.hpmicro.com 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。

